การพัฒนามอดูลเซลล์สุริยะเคมีไฟฟ้าเชิงแสงต้นทุนต่ำ



จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) are the thesis authors' files submitted through the University Graduate School.

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคนิค ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DEVELOPMENT OF LOW-COST PHOTOELECTROCHEMICAL SOLAR CELL MODULES



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Program in Chemical Technology Department of Chemical Technology Faculty of Science Chulalongkorn University Academic Year 2017 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การพัฒนามอดูลเซลล์สุริยะเคมีไฟฟ้าเชิงแสงต้นทุนต่ำ
โดย	นายวีระยุทธ์ เก้าเอี้ยน
สาขาวิชา	เคมีเทคนิค
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ดร. ณัฏฐพล ภู่ตระกูลโชติ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิจ	y)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	
	ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ เรียบร้อย	ແຈຈີญ)
	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ดร. ณัฏฐพล ภู่ตระกูลโชติ)	
	กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)	3
	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ สุดยอดสุ	ข) ยาลัย
	NIVERSITY

วีระยุทธ์ เก้าเอี้ยน : การพัฒนามอดูลเซลล์สุริยะเคมีไฟฟ้าเชิงแสงต้นทุนต่ำ (DEVELOPMENT OF LOW-COST PHOTOELECTROCHEMICAL SOLAR CELL MODULES) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ดร. ณัฏฐพล ภู่ตระกูลโชติ, 86 หน้า.

งานวิจัยนี้มุ่งหวังพัฒนาต้นแบบมอดูลเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง (DSSC) ขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการขยายส่วนการผลิตมอดูล ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูป พลังงาน ต้นทุนในการผลิต และเสถียรภาพของมอดูล ส่วนแรกสังเคราะห์สารประกอบนิกเกิลเซเล ในด์ (Ni_{0.85}Se) ด้วยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอลเพื่อเตรียมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วมทดแทนการใช้โลหะแพลททินัม ้ที่มีราคาแพง ส่วนที่สองสังเคราะห์เจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ (GPE) โดยผสมสารอะเซตาไมด์เข้ากับ โพลิเอททิลีนออกไซด์ โซเดียมไอโอไดด์ และไอโอดีน เพื่อทดแทนการใช้อิเล็กโทรไลต์เหลว ผลการ ทดสอบสมรรถนะของเซลล์ทดสอบขนาดพื้นที่รับแสง 0.25 cm² พบว่าเซลล์ทดสอบ DSSC ที่ใช้ Ni_{0.85}Se เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม และเซลล์ทดสอบ DSSC ที่ใช้ GPE ผสมสารอะเซตาไมด์ร้อยละ 8 โดยน้ำ หนัก ให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้า (PCE) = 2.6% และ 2.7 % ตามลำดับ ใกล้เคียงกับผลของเซลล์ควบคุมที่ใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมโลหะแพลททินัมและอิเล็กโทรไลต์เหลว (PCE = 3.0%) อย่างไรก็ตามเซลล์ทดสอบ DSSC ที่ใช้ทั้งขั้วไฟฟ้าร่วม Ni_{0.85}Se และ GPE ในเซลล์ เดียวกัน ให้ค่า PCE = 2.2% จากผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการนำไปสู่การพัฒนาเซลล์ แสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่รับแสงขนาดใหญ่ขึ้น ผลการทดสอบสมรรถนะของเซลล์ทดสอบขนาดพื้นที่รับ แสง 2.25 cm² พบว่าเซลล์ควบคมและเซลล์ทดสอบที่ใช้ทั้งขั้วไฟฟ้าร่วม Ni0.85Se และ GPE ใน เซลล์เดียวกัน ให้ค่า PCE = 2.8% และ 1.4% ตามลาดับ สรุปได้ว่าเมื่อขยายขนาดพื้นที่รับแสง สมรรถนะของเซลล์ทดสอบ DSSC ที่ใช้ทั้งขั้วไฟฟ้าร่วม Ni0.85Se และ GPE ในเซลล์เดียวกัน ลดต่ำ ้ลงจากเซลล์ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ผลการวิเคราะห์พบว่าความต้านทานอนุกรมในเซลล์เพิ่มขึ้นตาม ขนาดของพื้นที่รับแสง เบื้องต้นแก้ไขด้วยการปรับปรุงสภาพการนำไฟฟ้าโดยเพิ่มเส้นทางถ่ายโอน ้อิเล็กตรอนบนหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าทั้งสองด้านของเซลล์ทดสอบ ผลที่ได้จะนำไปประยุกต์ในเซลล์ ทดสอบที่มีพื้นที่รับแสงขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป

้คำสำคัญ : เซลล์สุริยะชนิดสียอมไวแสง, เจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์, ขั้วไฟฟ้าร่วมนิเกิลเซเลไนด์

ภาควิชา เคมีเทคนิค สาขาวิชา เคมีเทคนิค ปีการศึกษา 2560

ลายมือชื่อนิสิต	
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก	

KEYWORDS:

WEERAYUT KAO-IAN: DEVELOPMENT OF LOW-COST PHOTOELECTROCHEMICAL SOLAR CELL MODULES. ADVISOR: NUTTAPOL POOTRAKULCHOTE, Ph.D., 86 pp.

This research aims to develop the large area dye-sensitized solar cell (DSSC) modules considering parameters affecting DSSC scale-up process, photoconversion efficiency and the manufacturing cost. The first part involved synthesis of Nickel Selenide compound (Ni_{0.85}Se) using hydrothermal method to replace the costly Platinum counter electrode (CE). The second part was the preparation of gel polymer electrolyte (GPE) by mixing acetamide with poly(ethylene oxide), sodium iodide and iodine to replace the typical liquid electrolyte in DSSC. The performance test results of lab-scale DSSCs having irradiation area of 0.25 cm² showed that the DSSC test devices based on Ni_{0.85}Se CE and based on GPE with 8% by weight of acetamide yield photoconversion efficiency (PCE) of 2.6% and 2.7%, respectively. The values are acceptable in comparison with that of controlled test device employing Pt CE and liquid electrolyte (PCE = 3.0%). However, the DSSC incorporating Ni_{0.85}Se CE and GPE in the same device yields PCE = 2.2%. The devices were then scaled up nine times larger so that the irradiation area became 2.25 cm^2 . The performance test results of controlled DSSCs embedding Pt CE / liquid electrolyte and DSSCs based on Ni_{0.85}Se CE / GPE showed PCE = 2.8% and 1.4%, respectively. Further analysis revealed that the series resistance of solar cell increases with an increasing area of illumination, causing a significantly lower PCE value in Ni0.85Se CE/GPE-based DSSCs compared to that of the controlled device. Preliminary countermeasure includes enhancing the electrical conductivity by adding conductive pathways on the surface of both cell electrodes. The results provide base knowledge for further scaling up DSSC devices having larger area of illumination.

Department:	Chemical Technology	Student's Signature
Field of Study:	Chemical Technology	Advisor's Signature
Acadomic Voar	2017	
ACQUEITIC TEAL	ZUII	

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นจากความกรุณาจากหลายๆฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ ดร.ณัฏฐพล ภู่ตระกูลโซติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และคำปรึกษาในทุกๆด้าน ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้งานวิทยานิพันธ์ฉบับนี้สำเร็จโดยสมบูรณ์ ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาเคมีเทคนิคที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆในการ วิจัยมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ ประธาน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร. พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข กรรมการภายนอก ที่กรุณารับเชิญเป็นกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คำแนะนำ ความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการทาวิทยานิพนธ์ให้มี ความสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ ผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและทุนผู้ช่วยวิจัย ได้แก่ ทุนเพิ่ม ศักยภาพส่วนงานในด้านการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ 2558 – 2559 ตาม สัญญาเลขที่ GF_58_08_23_01 จัดสรรโดยฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ และทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จัดสรรโดยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ วิทยาลัยปิโตรเลียม และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์ ภาควิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข สถาบันวิทยสิริเมธี ผู้ให้ความอนุเคราะห์ทดสอบสมรรถนะของเซลล์ทดสอบ

ขอขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ในภาควิชาเคมีเทคนิค ที่คอยให้ความ ช่วยเหลือ คำแนะนำและเป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์นี้ให้บรรลุผลสำเร็จ

สุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆด้านตลอดมาจนสำเร็จ การศึกษา

หน้า
มทคัดย่อภาษาไทยง
มทคัดย่อภาษาอังกฤษจ
โตติกรรมประกาศฉ
กรบัญช
กรบัญตารางฏ
กรบัญภาพฏ
าำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อที่ใช้ในการวิจัย
มทที่ 1 บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา1
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.2 วัตถุประสงค์
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
1.5 ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย2
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการณ์แนะกลาดเกล้าย
มทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 สารกึ่งตัวนำ (semiconductor)
2.2 รอยต่อ P-N junction7
2.3 เส้นทางการพัฒนาสู่เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง [3]9
2.4 องค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง11
2.5 หลักการทำงานของ DSSC [4]12
2.6 ระบบสีย้อมไวแสงและแนวทางการพัฒนา13
2.7 ระบบสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์

	หน้า
2.8 ระบบขั้วไฟฟ้าร่วมและแนวทางการพัฒนาระบบ	
2.9 ระบบอิเล็กโทรไลต์และแนวทางการพัฒนาระบบ	
2.10 พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์	
2.11 การวัดประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า	21
2.12 วงจรสมมูลของเซลล์สุริยะ [15]	25
2.13 ปัจจัยที่ลดทอนประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะ	26
2.14 เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิงเคมีไฟฟ้า (Electrochemical Impedance	
Spectroscopy: EIS)	29
2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
บทที่ 3 เครื่องมือและวิธีการทดลอง	
3.1 สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย	
3.2 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย	
3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์	
3.5 วิธีดำเนินงานวิจัย	
3.5.1 การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานวิจัย	
3.5.2 เซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสง	
3.5.2.1 การเตรียมขั้วไฟฟ้ารับแสง	
3.5.2.2 การเตรียมขั้วไฟฟ้าร่วม	41
3.5.2.3 การประกอบเซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสง	
3.5.2.4 การทดสอบเซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสง	
3.5.3 เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมระดับห้องปฏิบัติการ	
3.5.3.1 การเตรียม Nickel selenide	

v	เน้า
3.5.3.2 การเตรียมขั้วไฟฟ้าร่วม	.44
3.5.3.3 การประกอบ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วม	.44
3.5.3.4 การวิเคราะห์สารที่เตรียมได้และการทดสอบ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้า	
ร่วม	.44
3.5.4 เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์ระดับ	
ห้องปฏิบัติการ	. 46
3.5.4.1 การเตรียม GPE	46
3.5.4.2 การประกอบ DSSC ที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์	.46
3.5.4.3 การวิเคราะห์สารที่เตรียมได้และการทดสอบ DSSC ที่ปรับปรุง สารละลายอิเล็กโทรไลต์	. 46
3.5.5 เซลล์ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ระดับ ห้องปฏิบัติการ	. 48
3.5.6 ออกแบบและทดสอบมอดูลเซลล์ DSSC ที่มีพื้นที่รับแสงขนาดไม่เกิน 30 × 30	18
าเหพื่ 4 ยอการพดอองและวิการณ์ยอการพดออง	52
	JZ
4.1 ผลวเคราะหดวยเทคนคเอกซเรยดพแพรกซนเพอยนยนองคบระกอบและเครงสรางผลก ของสารประกอบบิกเกิลเซเลไบด์ที่เตรียบได้	52
4.2 ผลวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อดูสัณฐานวิทยาของ อนุภาคสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้	. 53
4.3 ผลวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี เพื่อดูการรีดิวซ์และการออกซิไดซ์ของขั้ว นิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้เทียบกับขั้วแพลททินัม ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี	. 54
4.4 ศึกษาความโปร่งแสงของขั้วไฟฟ้าร่วมเคลือบสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้เทียบ กับแพลทนินัมด้วยยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์	. 57
4.5 ผลศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมเทียบกับ เซลล์สุริยะมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ	. 58

	หน้า
4.6 ศึกษาค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วและค่าการเหนียวนำไอออนของ GPE ที สังเคราะห์ได้	60
4.7 ผลศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ	62
4.8 ผลศึกษาประสิทธิภาพของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ	64
4.9 ผลวิเคราะห์ความต้านทานบริเวณหน้าสัมผัสของวัสดุในเซลล์สุริยะระดับห้องปฏิบัติการ ด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิงเคมีไฟฟ้าในสภาวะมืด	66
4.10 ผลศึกษาประสิทธิภาพของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐาน โดยมีพื้นที่รับแสงเป็น 2.25 cm²	70
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	74
5.1 สรุปผลการทดลอง	74
5.2 ข้อเสนอแนะ	76
รายการอ้างอิง	77
ภาคผนวก ก	81
ภาคผนวก ขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	82
ภาคผนวก ค. CHULALONGKORN UNIVERSITY	83
ภาคผนวก ง	84
ภาคผนวก จ	85
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	86

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3.1 การตั้งย่านการวัดให้เหมาะสมต่อการวัดค่าความต้านทาน	47
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทางเคมีไฟฟ้าจากไซคลิกโวลแทมมาแกรมจากรูปที่ 4.3	. 55
ตารางที่ 4.2 ประสิทธิภาพและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมเทียบกับ	
เซลล์สุริยะมาตรฐาน พื้นที่รับแสง 0.25 cm² วัดภายไต้แสงอาทิตย์จำลอง ความเข้มแสง AM 1.5 G (~100 mW/cm²)	.59
ตารางที่ 4.3 ค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วและค่าการเหนี่ยวนำไอออนของ GPE ที่ไม่มี การผสมและมีการผสมสารอะเซตาไมด์ตามอัตราที่กำหนด	61
ตารางที่ 4.4 ประสิทธิภาพและพารามิเตอร์ต่างๆของ DSSC ที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐาน พื้นที่รับแสง 0.25 cm² วัดภายใต้แสงอาทิตย์จำลอง ความเข้มแสง AM 1.5 G (~100 mW/cm²)	. 63
ตารางที่ 4.5 ประสิทธิภาพและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและ สารละลายอิเล็กโทรไลต์เทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐาน พื้นที่รับแสง 0.25 cm ²	65
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลค่าพารามิเตอร์ จาก EIS ที่แรงดันไบแอสประมาณ 0.7 V	69
ตารางที่ 4.7 ประสิทธิภาพและพารามิเตอร์ต่างๆของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและ สารละลายอิเล็กโทรไลต์เทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐาน ขนาดพื้นที่รับแสง 2.25 cm ²	.70

สารบัญภาพ

รูปที่ 2.1 ผลึกซิลิคอนที่มีสภาพนำภายใน [2]	5
รูปที่ 2.2 ผลึกของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ (pure silicon) สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (n-type silicon)	5
รูปที่ 2.3 ช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (energy gap) แถบวาเลนซ์ (valence band) และ	
แถบนำไฟฟ้า (conduction band) ของฉนวน สารกึ่งตัวนำ และโลหะ[2]	6
รูปที่ 2.4 รูปตัวอย่างระดับพลังงานเฟอมิของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ [2]	7
รูปที่ 2.5 รูปตัวอย่างระดับพลังงานเฟอมิของสารกึ่งตัวนำแบบ N-Type และ P-Type [2]	7
รูปที่ 2.6 ระดับเฟอร์มิที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อ P-N junction [2]	8
รูปที่ 2.7 บริเวณการพร่องที่บริเวณรอยต่อ P-N junction [2]	8
รูปที่ 2.8 การเกิด Electron-hole pair บริเวณรอยต่อ P-N junction [2]	9
รูปที่ 2.9 องค์ประกอบภายในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง	. 11
รูปที่ 2.10 การไหลของอิเล็กตรอนในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง	. 12
รูปที่ 2.11 สีย้อมไวแสงกลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูธิเนียมกับลิแกนด์โพลีไพริดีน [3]	. 14
รูปที่ 2.12 สีย้อมไวแสงสารอินทรีย์กลุ่ม เคามาริน [3]	. 14
รูปที่ 2.13 สีย้อมไวแสงสารอินทรีย์กลุ่ม เพอริลีน [3]	. 15
รูปที่ 2.14 โมเลกุลของคลอโรฟิลล์และ Cu-MP [3]	. 15
รูปที่ 2.15 สีย้อมไวแสงพอร์ไฟริน Zn-TCPP [3]	. 16
รูปที่ 2.16 สีย้อมไวแสงพอร์ไฟริน meso-linkes [3]	. 16
รูปที่ 2.17 ค่าพลังงานแถบช่องว่างของสารกึ่งตัวนำ [6]	. 17
รูปที่ 2.18 ลักษณะการเคลื่อนที่ของไอออนลิเธียมผ่านตัวกลางพอลิเมอร์ชนิด PEO [12]	. 20
รูปที่ 2.19 สเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย์ AM 0.0 และ AM 1.5 [14]	. 22
รูปที่ 2.20 วิธีการหาค่าฟิลล์แฟกเตอร์ของเซลล์สุริยะ	. 24
รูปที่ 2.21 ลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (I-V curve) ของเซลล์สุริยะ	. 24

รูปที่ 2.22 แบบจำลองวงจรมูลของเซลล์สุริยะ	25
รูปที่ 2.23 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะ	26
รูปที่ 2.24 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะที่ความเข้มแสง 1.5 อาทิตย์	27
รูปที่ 2.25 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะที่ความเข้มแสง 1.0 อาทิตย์	27
รูปที่ 2.26 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะต่ออุณหภูมิ	28
รูปที่ 2.27 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะต่อความต้านทานอนุกรม	28
รูปที่ 2.28 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะต่อความต้านทานชันท์	29
รูปที่ 2.29 ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าฟังก์ชันไซน์ในวงจรกระแสสลับที่มีความต่างเฟสØ	31
รูปที่ 2.30 a) Nyquist plot ของวงจร และ b) วงจรตัวต้านทานขนานกับตัวเก็บประจุ	31
รูปที่ 2.31 แสดง Nyquist plot ทั่วไปของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง	32
รูปที่ 2.32 รูปแบบวงจรสำหรับการฟิตติ้งผลการทดลอง EIS	32
รูปที่ 2.33 ค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสัมผัสและค่าความต้านทานของสารอิเล็กโทร	
ไลต์	33
Contraction (Contraction)	

	ine and in the second sec	
รูปที่ 3	3.1 ส่วนประกอบของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง	39
รูปที่ 3	3.2 ขั้นตอนการเตรียมขั้วไฟฟ้ารับแสง	41
รูปที่ 3	3.3 ขั้นตอนการเตรียมเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด	42
รูปที่ 3	3.4 เซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสงที่ประกอบสำเร็จ	42
รูปที่ 3	3.5 ภาชนะ Teflon-lined autoclave	44
รูปที่ 3	3.6 วิธีการเซตอุปกรณ์และสารที่ใช้ในการทำไซคลิกโวลแทมเมตรี	45
รูปที่ 3	3.7 การเตรียมขั้วในฝั่ง working	45
รูปที่ 3	3.8 หน่วยวัดพื้นฐานของเครื่องมัลติมิเตอร์	47
รูปที่ 3	3.9 ขั้นตอนการออกแบบโดยเพิ่มพื้นที่รับแสงของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง	48
รูปที่ 3	3.10 บล็อคสกรีนมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากระดับห้องปฏิบัติการ 9 เท่า	49

รูปที่ 3.11 ลำดับการเตรียมขั้วไฟฟ้ารับแสงของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง ที่มีพื้นที่รับแสง 2.25 cm² ก) Pretreatment FTO ข) พิมพ์สกรีน TiO ₂ ค) หลังจากผ่านการเผ่า ง) หลังจากแช่	
Dye Z907	. 50
รูปที่ 3.12 การทาสีเพ้นท์เงินบนเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง	. 50
รูปที่ 3.13 เซลล์ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ พื้นที่รับแสง 2.25 cm ² ที่ประกอบสำเร็จ	. 51
รูปที่ 4.1 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์	. 53
รูปที่ 4.2 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของสารประกอบนิกเกิลเซเล ไนด์ ความละเอียด 20,000 เท่า (ซ้าย) และ 10,000 เท่า (ขวา)	. 53
รูปที่ 4.3 ไซคลิกโวลแทมมาแกรมของขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้เปรียบเทียบกับขั้วแพลททินัม	. 54
รูปที่ 4.4 ค่าความโปร่งแสงของขั้วไฟฟ้าร่วมที่เคลือบด้วยโลหะแพลททินัมและสารนิกเกิลเซเล ไนด์	. 57
รูปที่ 4.5 ลักษณะของขั้วไฟฟ้าร่วมที่เคลือบด้วยโลหะแพลททินัม (ซ้าย) และสารนิกเกิลเซเลไนด์ (ขวา)	. 57
รูปที่ 4.6 เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมเป็นโลหะแพลททินัม (ซ้าย) และสาร นิกเกิลเซเลไนด์ (ขวา)	. 58
รูปที่ 4.7 ส่วนประกอบของ NiSe-DSSC	. 58
รูปที่ 4.8 กราฟ J-V ของเซลล์ NiSe-DSSC (พื้นที่รับแสง 0.25 cm ²)	. 59
รูปที่ 4.9 DSC thermograms ของ GPE ที่เตรียมได้	. 60
รูปที่ 4.10 แบบจำลอง Fringed-micelle แสดงโครงสร้างผลึกพอลิเมอร์ [26]	.61
รูปที่ 4.11 ส่วนประกอบของ GPE-DSCC	. 62
รูปที่ 4.12 กราฟ J-V ของ GPE-DSSC (พื้นที่รับแสง 0.25 cm ²)	. 63
รูปที่ 4.13 ส่วนประกอบของ NiSe/GPE-DSSC	. 64
รูปที่ 4.14 กราฟ J-V ของ NiSe/GPE-DSSC (พื้นที่รับแสง 0.25 cm ²)	. 64

รูปที่ 4.15 ก) รูปแบบวงจรสำหรับการฟิตติ้งผลการทดลอง EIS, ข) R _{ct} ที่ bias voltage				
แตกต่างกันของ DSSC มาตรฐาน และDSSC ที่ปรับปรุงส่วนประกอบ, ค) Z _w ที่ bias voltage				
แตกต่างกันของ DSSC มาตรฐาน และDSSC ที่ปรับปรุงส่วนประกอบ, ง) R _{ce} ที่ bias voltage				
แตกต่างกันของ DSSC มาตรฐาน และDSSC ที่ปรับปรุงส่วนประกอบ	67			
รูปที่ 4.16 ปฏิกิริยา recombination via electrolyte	68			
รูปที่ 4.17 กราฟ J-V ของเซลล์ NiSe/GPE-DSSC ขนาดพื้นที่รับแสง 2.25 cm ²	71			



Chulalongkorn University

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อที่ใช้ในการวิจัย

DSSC Dye-sensitized solar cell เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง

Counter electrode ขั้วไฟฟ้าร่วม CE กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่เครื่องกำเนิดแสงจ่ายให้กับวงจรภายนอก [W] P_{max} กำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดแสงที่ตกกระทบบนเซลล์สุริยะ [W] P_{in} ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่เซลล์ผลิตได้ [mA/cm²] J_{max} ศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่เซลล์ผลิตได้ [V] V_{max} Power conversion efficiency ค่าประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะ [%] PCE Fill Factor ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ [-] FF Short circuit current density ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าลัดวงจร [mA/cm²] J_{sc} Open circuit voltage ศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด [V] V_{oc} กระแสไฟฟ้าขาออก [A] L กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งพลังงานแสง [A] I_I กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไดโอด [A] I_{D} กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานชันท์ [A] I_{SH} แรงดันไฟฟ้าขาออก [V] V ความต้านทานอนุกรม [Ohm] R_S ค่าสัมบูรณ์ของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงสุดจากปฏิกิริยารีดักชัน [mA/cm²] $|J_{red}|$ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงสุดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน [mA/cm²] Jox ความต่างของศักย์ไฟฟ้าที่เกิด J_{red} เทียบกับศักย์ไฟฟ้าที่เกิด J_{ox} [V] Epp ้ค่าการนำไอออนในเจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ [S/cm] σ ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า [cm] L ความต้านทาน bulk, ความทานต้านของเจลพอลิเมอร์ [Ohm] R_{b} พื้นที่หน้าตัดของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ [cm²] А

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

้ ปัจจุบันจำนวนประชากรของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิด การขาดแคลนพลังงานในอนาคตอันใกล้ ปัญหาสำคัญของแหล่งพลังงานหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในปัจจุบันของประเทศไทยอันประกอบด้วยถ่านหินและแก๊สธรรมชาติคือมีปริมาณจำกัดและมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การหาแหล่งพลังงานทดแทนและใช้ได้ไม่มีวันหมดถือเป็นงานเร่งด่วนที่ต้อง รีบดำเนินการ พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะแสงอาทิตย์มีพลังงานมหาศาลที่ สามารถนำมาใช้งานได้อย่างไม่มีวันหมด เซลล์สุริยะ (solar cell) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น ระยะเวลากว่า 60 ปีเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สาหรับเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้า โดยตรง อย่างไรก็ตามเซลล์สุริยะมีต้นทุนการผลิตสูง ไม่สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์เมื่อเปรียบเทียบ ้กับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน ปิโตรเลียม หรือก๊าชธรรมชาติ ดังนั้นเซลล์สุริยะต้นทุนต่ำจึงเป็น ทางออกที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-sensitized solar cell; DSSC) เป็นทางเลือกสำคัญในการพัฒนาเซลล์สุริยะต้นทุนต่ำโดยอาศัยหลักการเคมีไฟฟ้าเชิง แสงที่มีชั้นสีย้อม (Dye-sensitized) ทำหน้าที่ดูดกลืนแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ผลงานวิจัย ้ล่าสุดพบว่าเซลล์สุริยะ DSSC ให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานสูงสุด 11.9% [1] งานวิจัยนี้ สนใจการพัฒนารูปแบบการผลิตเซลล์สุริยะ DSSC โดยจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเซลล์สุริยะ ขนาดใหญ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์สุริยะ รวมถึงทดลองผลิตต้นแบบมอดูล เซลล์สุริยะ DSSC ที่มีพื้นที่รับแสงขนาดไม่มากกว่า 30 x 30 cm² สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเซลล์ สุริยะ DSSC ระดับนาร่อง และระดับอุตสาหกรรมต่อไป เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ตลอดจน ตอบสนองต่อนโยบายพลังงานทดแทนแห่งชาติ

1.3 สมมติฐานการวิจัย

การสังเคราะห์สาร Nickel selenide ใช้แทนขั้วไฟฟ้าร่วม (แพลททินัม) และสังเคราะห์เจลพอลิเมอร์ อิเล็กโทรไลต์ใช้แทนสารอิเล็กโทรไลต์เหลวในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง เพื่อช่วยลดต้นทุนในการ ผลิตและช่วยเพิ่มความเสถียรภาพของเซลล์สุริยะ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลิตมอดูลเซลล์สุริยะชนิด สีย้อมไวแสงมีพื้นที่รับแสงขนาดไม่มากกว่า 30 × 30 ตารางเซนติเมตร

1.2 วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเซลล์สุริยะขนาดใหญ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของ เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงระดับห้องปฏิบัติการ

 เพื่อศึกษาและผลิตมอดูลเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงมีพื้นที่รับแสงขนาดไม่มากกว่า 30 x 30 ตารางเซนติเมตร

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเซลล์สุริยะขนาดใหญ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ของเซลล์สุริยะและเสถียรภาพของเซลล์สุริยะ รวมถึงทดลองผลิตต้นแบบมอดูลเซลล์สุริยะ ชนิดสีย้อม ไวแสงที่มีพื้นที่รับแสงขนาดไม่มากกว่า 30 × 30 ตารางเซนติเมตร

1.5 ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย

- 1.5.1 ค้นคว้าทฤษฏีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.5.2 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานวิจัย
- 1.5.3 จัดเตรียมส่วนประกอบของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่เหมาะสม
 - สีย้อมไวแสง
 - ขั้วไฟฟ้ารับแสง
 - ขั้วไฟฟ้าร่วม
 - สารละลายอิเล็กโทรไลต์

 1.5.4 ประกอบและวิเคราะห์สมรรถนะของเซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสงระดับ ห้องปฏิบัติการ

- 1.5.5 จัดเตรียมการประกอบเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงขนาดใหญ่
 - ใช้ Nickel selenide เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

- ใช้เจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์เป็นสารอิเล็กโทรไลต์

1.5.6 วิเคราะห์สาร Nickel selenide ที่ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมและเจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ที่ใช้เป็น สารละลายอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง

- ศึกษาโครงผลึกของสาร Nickel selenide ที่เตรียมได้

- ศึกษาโครงสร้างสัณฐานของ Nickel selenide ที่เตรียมได้

- ศึกษาความโปร่งแสงของ Nickel selenide ที่เตรียมได้

- ศึกษาการรีดิวซ์และการออกซิไดซ์ของสาร Nickel selenide ที่เตรียมได้

- ศึกษาค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของเจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์

- ศึกษาค่าการเหนี่ยวนำไอออน (Ionic conductivity) ของเจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์

 1.5.7 ประกอบและวิเคราะห์สมรรถนะของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงระดับห้องปฏิบัติการที่ ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์

1.5.8 ออกแบบและทดสอบมอดูลเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่มีพื้นที่รับแสงขนาดไม่เกิน 30 x 30 ตารางเซนติเมตร

1.5.9 การวิเคราะห์สมรรถนะของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง

- ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

- วัดค่าความต้านทานของการถ่ายเทอิเล็กตรอนบริเวณผิวสัมผัส

1.5.10 วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และเขียนวิทยานิพนธ์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทคนิคการผลิตต้นแบบมอดูลเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่มีพื้นที่รับแสงขนาดไม่มากกว่า 30 x 30 ตารางเซนติเมตร ที่มีประสิทธิภาพการทำงานและต้นทุนในการผลิตของเซลล์สุริยะที่เหมาะสม มี เสถียรภาพเหมาะแก่การใช้งานในระยะยาว

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

พลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ การผลิตกระแสไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งมีปริมาณ อย่างจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานอื่น ๆ มาทดแทน เช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม และ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น แหล่งพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด ไม่ให้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดนั้นคือ พลังงานแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์นอกจากจะใช้เป็นแหล่ง พลังงานความร้อน ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงด้วยเซลล์สุริยะ (solar cell) เซลล์สุริยะชนิดรอยต่อ P-N ของสารกึ่งตัวนำผลึกเดี่ยวซิลิคอนได้ถูกพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันได้มีการผลิตเซลล์สุริยะชนิดรอยต่อ P-N ของสารกึ่งตัวนำผลึกเงี่ยวพิลิคอน ในเชิง พาณิชย์

2.1 สารกึ่งตัวนำ (semiconductor)

สารกึ่งตัวนำ คือวัสดุที่มีความกว้างของช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (energy gap) อยู่ระหว่างสารนำ ไฟฟ้า (conductor) กับฉนวน (insulator) ได้แก่ ซิลิคอน (Si) และเจอร์มาเนียม (Ge) ซึ่งวัสดุจำพวก นี้ใช้เป็นชิ้นส่วนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สภาพนำภายใน (Intrinsic semiconductor) เป็นสมบัติของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ที่สามารถนำไฟฟ้า ได้ด้วยตัวเองด้วยโครงสร้างอะตอมของธาตุชนิดเดียว แสดงดังรูปที่ 2.1 เมื่อสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ถูก กระตุ้นด้วยพลังงานความร้อนหรือกระแสไฟฟ้า อิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์ (valence band) จะหลุด จากโครงสร้างอะตอม ข้ามช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (Energy band gap) ขึ้นไปอยู่ในแถบนำ ไฟฟ้า (conduction band) แล้วสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกันแถบวาเลนซ์ที่ สูญเสียอิเล็กตรอนจะเกิดหลุม (hole) ที่สามารถรับอิเล็กตรอนจากอะตอมข้างเคียง



รูปที่ 2.1 ผลึกซิลิคอนที่มีสภาพนำภายใน [2]

สภาพนำภายนอก (Extrinsic conductivity)เป็นสมบัติการนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ที่Dope ด้วยธาตุเจือปนที่มีโครงสร้างอิเล็กตรอนต่างกันลงไปในโครงสร้างผลึกบริสุทธิ์แบ่งเป็น 2 แบบ แสดง ดังรูปที่ 2.2

สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (n-type semiconductor) เช่น การเจืออะตอมของธาตุฟอสฟอรัส
(P) ลงในโครงสร้างผลึกของซิลิคอน คือ การเจือด้วยอะตอมของธาตุที่มีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่า
จำนวนอิเล็กตรอนของอะตอมโครงสร้างผลึก ทำให้มีจำนวนอิเล็กตรอนเกินในโครงสร้างผลึก

- สารกึ่งตัวนำชนิดพี (p-type semiconductor) เช่น การเจืออะตอมของธาตุโบรอน (Br) ลงในโครงสร้างผลึกของซิลิคอน คือ การเจือด้วยอะตอมของธาตุที่มีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่า จำนวนอิเล็กตรอนของอะตอมโครงสร้างผลึก ทำให้มีจำนวนหลุมอิเล็กตรอนเกินในโครงสร้างผลึก ซึ่ง หลุมอิเล็กตรอนที่เกินมานี้สามารถรับอิเล็กตรอนจากอะตอมข้างเคียงต่อเนื่องกันไป ซึ่งคล้ายกับหลุม เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ



รูปที่ 2.2 ผลึกของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ (pure silicon) สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (n-type silicon) และสารกึ่งตัวนำชนิดพี (p-type silicon) [2]

แบบจำลองแถบพลังงาน (Energy band model) เป็นแบบจำลองที่เกิดขึ้นเมื่ออะตอม ของธาตุรวมตัวกันเป็นโมเลกุลในโครงสร้างของเนื้อวัสดุแข็งจำพวกฉนวน, สารกึ่งตัวนำ และโลหะ ดัง รูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 ช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (energy gap) แถบวาเลนซ์ (valence band) และแถบนำไฟฟ้า (conduction band) ของฉนวน สารกึ่งตัวนำ และโลหะ[2]

ระดับพลังงานย่อยของอิเล็กตรอนในกลุ่มอะตอมจะรวมตัวกันเกิดเป็นแถบพลังงาน (energy band) ที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (energy gap หรือ band gap; Eg) ที่ไม่มี อิเล็กตรอน แถบพลังงานชั้นในบริเวณที่อยู่ใกล้กับนิวเคลียสของกลุ่มอะตอมจะมีพลังงานต่ำ แถบวา เลนซ์ (valence band) เป็นแถบพลังงานของอะตอมที่สร้างพันธะระหว่างกันเกิดเป็นโครงสร้างทำให้ อิเล็กตรอนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ส่วนแถบนำไฟฟ้า (conduction band) เป็นแถบพลังงานชั้นนอก จะมีพลังงานสูงกว่าและอิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

ระดับเฟอมิ (Fermi Level) เป็นระดับพลังงานสมมติ ซึ่งมีค่าสูงพอที่จะมีโอกาสพบ อิเล็กตรอนบรรจุอยู่ร้อยละ 50 ที่สภาวะสมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์ (thermodynamic equilibrium) ณ เวลาใด ๆ ในแบบจำลองแถบพลังงานที่มีการกระจายตัวของอิเล็กตรอนในระดับ พลังงานต่าง ๆ เป็นไปตามฟังก์ชันของเฟอร์มิ-ดิแรก (Fermi-Dirac distribution function) สารกึ่ง ตัวนำบริสุทธิ์มีระดับพลังงานเฟอร์มิอยู่ที่กึ่งกลางของช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน แสดงดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 รูปตัวอย่างระดับพลังงานเฟอมิของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ [2]

ส่วนสารกึ่งตัวนำแบบN-Type จะมีระดับพลังงานเฟอร์มิใกล้แถบนำไฟฟ้าและแบบ P-Type จะมี ระดับพลังงานเฟอร์มิอยู่ใกล้แถบวาเลนซ์ แสดงดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 รูปตัวอย่างระดับพลังงานเฟอมิของสารกึ่งตัวนำแบบ N-Type และ P-Type [2]

2.2 รอยต่อ P-N junction

เมื่อนำสารกึ่งตัวนำแบบ N-Type และ P-Type ที่มีระดับพลังงานเฟอร์มิที่ต่างกันมาเชื่อมต่อ กันจะทำให้เกิดรอยต่อ P-N junction เกิดขึ้น แสดงดังรูปที่ 2.6 อิเล็กตรอนฝั่ง N-Type จะแพร่ไปฝั่ง P-Type และในขณะเดียวกัน โฮลจะเคลื่อนที่แพร่ไปยังทิศตรงข้าม ในบริเวณแคบ ๆ ใกล้กับรอยต่อ P-N junction มีแรงเหนี่ยวนำระหว่างประจุลบและประจุบวกที่สะสมในแต่ละฝั่งทำให้เกิดศักย์ภายใน (built-in potential) ขึ้นต่อต้านการแพร่ของประจุจากทั้งสองฝั่ง การแพร่จะดำเนินไปจนกว่าระดับ พลังงานเฟอร์มิของทั้งสองฝั่งอยู่ระดับเดียวกันจึงเข้าสู่สมดุล



รูปที่ 2.7 บริเวณการพร่องที่บริเวณรอยต่อ P-N junction [2]

ส่วนรูปที่ 2.7 คือบริเวณการพร่อง(depletion region) เป็นบริเวณแคบ ๆ ใกล้กับรอยต่อ P-N junction โดยบริเวณนี้ไม่มีการแพร่เกิดขึ้นเนื่องจากระดับพลังงานเฟอร์มิของฝั่ง N-Type และ P-Type อยู่ระดับเดียวกัน

คู่อิเล็กตรอน-หลุม (Electron-hole pair) คือ สภาพที่อิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์ (valence band) ของสารกึ่งตัวนำ ได้รับการกระตุ้นจากแสงไฟฟ้าหรือความร้อน ที่มีพลังงานเท่ากับ หรือมากกว่าช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (energy band) จนมีพลังงานสูงพอที่อิเล็กตรอนจะหลุด จากโครงสร้างอะตอมขึ้นไปอยู่ในแถบนำไฟฟ้า (conduction band) ทำให้เกิดหลุม (hole) ในแถบ วาเลนซ์ที่สูญเสียอิเล็กตรอนไป แสดงดังรูป 2.8



รูปที่ 2.8 การเกิด Electron-hole pair บริเวณรอยต่อ P-N junction [2]

ซึ่งจะคงสภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนที่อิเล็กตรอนจะสูญเสียพลังงานและเกิดการตกกลับ (recombination) ลงมายังแถบวาเลนซ์ตามเดิม คู่อิเล็กตรอน-หลุม ที่เกิดขึ้นตรงรอยต่อ P-N junction ในบริเวณการพร่องจะถูกเร่งด้วยศักย์ภายในให้แยกคู่กัน เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าไหลออกไปสู่ วงจรภายนอกได้ จำนวนคู่อิเล็กตรอน-หลุม และช่วงเวลาที่อิเล็กตรอนคงสภาพก่อนการตกกลับ (recombination lifetime) เป็นตัวกำหนดสมบัติการนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ และลักษณะเฉพาะ ทางไฟฟ้าของเซลล์สุริยะที่ประกอบขึ้นจากสารกึ่งตัวนำนั้น

2.3 เส้นทางการพัฒนาสู่เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง [3]

เซลล์สุริยะสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยอาศัยวิธีโฟโตโวล ทาอิก (photovoltaic) ซึ่งได้ถูกค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Antonie César Becquerel ใน ปี ค.ศ. 1839 พบว่า เมื่อแสงตกกระทบเซลล์อิเล็กโทรไลติกในส่วนขั้วไฟฟ้าโลหะ ทำให้มีกระแสไฟฟ้า เกิดขึ้น จากนั้น Russell Ohl ได้พัฒนาเซลล์สุริยะสารกึ่งตัวนำผลึกเดี่ยวซิลิคอนชนิดรอยต่อ P-N ที่ ห้องปฏิบัติการเบลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1941 และต่อมา Chapin และคณะ ได้พัฒนา เซลล์สุริยะสารกึ่งตัวนำซิลิคอนที่เป็นรอยต่อ P-N เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานของโครงการอวกาศเซลล์ สุริยะที่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 4% ในปี ค.ศ. 1954 และในเวลาอีกไม่กี่ปีต่อมา ได้พัฒนาเซลล์ให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 11% ซึ่งหลักการทำงานของเซลล์สุริยะชนิดนี้อาศัยการเกิดอิเล็กตรอน (electron, e⁻) และหลุม (hole, h⁺) อิสระที่รอยต่อP-N ของสารกึ่งตัวนำเมื่อมีแสงตกกระทบเมื่อต่อ เซลล์สุริยะกับวงจรไฟฟ้าภายนอกก็จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนและหลุมอิสระเกิดเป็นไฟฟ้า กระแสตรง สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงหรือสามารถเก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่ ในปี ค.ศ. 1958 ได้นำ เซลล์สุริยะชนิดรอยต่อ P-N ของสารกึ่งตัวนำไปใครงานกับดาวเทียม แวนการ์ด I เป็นครั้งแรก และ ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 บริษัท Hoffman Electronics สามารถผลิตเซลล์สุริยะที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 14% และหลังจากนั้นได้มีการพัฒนาเซลล์สุริยะชนิดนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเซลล์สุริยะ แบบรอยต่อ P-N ของสารกึ่งตัวนำได้แก่ เซลล์สุริยะชนิดผลึกซิลิคอนรูปทรงเดียว (monocrystalline silicon) และเซลล์สุริยะชนิดผลึกซิลิคอนหลายรูปทรง (polycrystalline silicon) เซลล์สุริยะชนิด ฟิล์มของซิลิคอนอสัณฐาน (amorphous silicon) นิยมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเซลล์สุริยะ ชนิดฟิล์มบางของโลหะผสมแกลเลียมอาร์เซไนด์ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าเซลล์สุริยะชนิดรอยต่อP-N ของสารกึ่งตัวนำมีประสิทธิภาพสูงแต่ยังไม่ได้รับ แต่มีราคาแพง นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากกระบวนการผลิตเซลล์สุริยะซิลิคอนต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ ต้องการซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง ทำให้เซลล์สุริยะชนิดนี้มีราคาแพงเกินไปที่จะซื้อใช้ในบ้านเรือน ทั่วไป ดังนั้นได้มีการพัฒนา เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง (dye-sensitized solar cell, DSSC) ขึ้นมา ในช่วงการพัฒนาแรก ๆ เซลล์สุริยะชนิดนี้ยังมีประสิทธิภาพต่ำ และได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของเซลล์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ Grätzel และคณะ (O'Regan and Grätzel, 1991) เป็นกลุ่มวิจัยที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการศึกษาโดยในปี ค.ศ. 1991 ได้พัฒนาเซลล์ให้มี ประสิทธิภาพสูงถึง 7% และในปี ค.ศ.1993 สูงถึง 10%

CHULALONGKORN UNIVERSITY

ในปัจจุบันทีมของ Grätzel ได้พัฒนาเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงให้ประสิทธิภาพในการ เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 11.18% และกำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากทั้งในเชิง วิชาการและในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากเซลล์สุริยะชนิดนี้สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูป พลังงานสูง มีกระบวนการผลิตที่ง่ายกว่าและมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเซลล์สุริยะฐานซิลิคอน

เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงเป็นเซลล์ที่อาศัยโมเลกุลของสีย้อมไวแสงในการดูดกลืนแสง ซึ่ง เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงมีการใช้สารกึ่งตัวนำที่เป็นสารประกอบโลหะออกไซด์ ที่มีเสถียรภาพสูง เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) และสีย้อมไวแสงที่เตรียมจากสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูทิ เนียมและลิแกนด์กลุ่มพิริดีน (Ru-pyridine complex) สารประกอบอินทรีย์ (organic compound) หรือรงควัตถุในธรรมชาติ (natural pigment) ที่มีสมบัติดูดกลืนแสงในย่านความถี่ของแสงอาทิตย์ได้ เซลล์สุริยะชนิดนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เซลล์เกรทเซล" (Grätzel Cell)



2.4 องค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง

รูปที่ 2.9 องค์ประกอบภายในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง

องค์ประกอบที่สำคัญในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง แสดงดังรูปที่ 2.9 ได้แก่ ขั้วไฟฟ้า สีย้อมไวแสง อนุภาคโลหะออกไซด์ และสารอิเล็กโทรไลต์ โดยแต่ละส่วนมีหน้าที่และสมบัติที่สำคัญดังนี้

 ขั้วไฟฟ้า ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้ารับแสงทำหน้าที่ถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปสู่วงจรภายนอกและ ขั้วไฟฟ้าร่วมทำหน้าที่ถ่ายโอนอิเล็กตรอนกลับคืนเข้ามายังเซลล์ ซึ่งนิยมใช้โลหะแพลททินัมเคลือบอยู่ บนกระจกเป็นขั้วไฟฟ้า CHULALONGKORN UNIVERSITY

สีย้อมไวแสง เป็นส่วนประกอบที่ยึดเกาะอยู่ที่ผิวของอนุภาคโลหะออกไซด์ที่เคลือบอยู่บน ขั้วไฟฟ้ารับแสงทำหน้าที่ดูดกลืนแสงอาทิตย์ทำให้อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นแล้วส่งผ่านอิเล็กตรอนไปยัง อนุภาคโลหะออกไซด์ ดังนั้นสีย้อมไวแสงต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น มีสเปกตรัมการดูดกลืนแสง กว้างในช่วงแสงที่มองเห็นได้และใกล้อินฟาเรดเพื่อดูดกลืนแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์ การดูดกลืนแสงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับโฟตอนที่ตกกระทบ มีระดับพลังงานของสภาวะพื้น และสภาวะเร้าที่เหมาะสม มีเสถียรภาพสูงในสภาวะถูกออกซิไดส์ และสามารถยึดเกาะบนผิวอนุภาค โลหะออกไซด์ได้ดี

อนุภาคโลหะออกไซด์ เป็นสารกึ่งตัวนำที่ทำหน้าที่เป็นชั้นให้โมเลกุลของสีย้อมไวแสงยึดเกาะ
รวมทั้งรับอิเล็กตรอนจากสีย้อมและส่งผ่านอิเล็กตรอนไปยังขั้วไฟฟ้ารับแสง จึงควรเป็นอนุภาคที่มี

พื้นที่ผิวมากและนำอิเล็กตรอนได้ดี นิยมใช้อนุภาคของโลหะออกไซด์ที่มีแถบพลังงานกว้าง (มากกว่า 3 eV) เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) และทินออกไซด์ (SnO₂) เป็นต้น - สารอิเล็กโทรไลต์ทำหน้าที่ชดเชยอิเล็กตรอนให้กับโมเลกุลสีย้อมไวแสงที่สูญเสียอิเล็กรอนไป

โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ (redox) กับขั้วไฟฟ้าร่วม



2.5 หลักการทำงานของ DSSC [4]

รูปที่ 2.10 การไหลของอิเล็กตรอนในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง

การไหลของอิเล็กตรอนในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง แสดงดังรูปที่ 2.10 เมื่อแสงตก กระทบเซลล์สุริยะ โมเลกุลสีย้อมไวแสงที่เกาะอยู่บนผิวของสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์จะดูดกลืนแสง เปลี่ยนสภาพจากสถานะพื้น (S^o) เป็นสถานะเร้า (S*) จากนั้นอิเล็กตรอนพลังงานสูงของโมเลกุลสีย้อม ในสถานะเร้า (S*) ถูกส่งผ่านไปสู่แถบนำไฟฟ้า (conduction band) ของสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ ซึ่งมีระดับพลังงานต่ำกว่า แล้วอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในชั้นสารกึ่งตัวนำจะถูกรวบรวมบริเวณ หน้าสัมผัส (front contact) จากนั้นจะเคลื่อนที่ออกสู่วงจรภายนอก สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่บรรจุ อยู่ระหว่างขั้วไฟฟ้ารับแสงและขั้วไฟฟ้าร่วมจะเกิดกระบวนการรีดอกซ์ โดยให้อิเล็กตรอนกับโมเลกุลสี ย้อมที่สูญเสียอิเล็กตรอน (S⁺) ทำให้โมเลกุลสีย้อมกลับสู่สถานะพื้น (S^o) ในขณะเดียวกันสารอิเล็กโทร ไลต์จะรับอิเล็กตรอนคืนจากขั้วไฟฟ้าร่วม โดยมีปฏิกิริยาหลักที่เกิดขึ้นคือ

Photoexcitation: $S^0 + h\mathbf{U} \rightarrow S^*$ Charge injection: $S^* \rightarrow S^+ + e^- (TiO_2)$

Dye regeneration:	S ⁺ + 2I [−] → S ⁰ + I_2^- และ $2I_2^-$ → I_3^- + I [−]
ปฏิกิริยารวมของ Dye regeneration:	$S^+ + \frac{3}{2}I^- \longrightarrow \frac{1}{2}I_3^- + S^0$
Electrolyte regeneration:	$\frac{1}{2}I_3^- + e^-(Pt) \longrightarrow \frac{3}{2}I^-$

2.6 ระบบสีย้อมไวแสงและแนวทางการพัฒนา

2.6.1 กลุ่มสีย้อมไวแสงจำพวกสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูธิเนียมกับลิแกนด์โพลีไพริดีน

สีข้อมไวแสงกลุ่มนี้ได้รับความสนใจและศึกษาพัฒนามาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากรูอิเนียม เป็นโลหะมีความต่างศักย์รีดอกซ์ (redox potential) สูง เหมาะสมสำหรับการกระตุ้นและส่งผ่าน อิเล็กตรอนไปยังอนุภาคนาโนของสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ออกไซด์ได้ดี Grätzel และคณะ (O'Regan and Grätzel, 1991; Nazeeruddin et al., 1997; Nazeeruddin et al., 2003; Cherepy et al., 1997) เป็นกลุ่มวิจัยแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาสีย้อมไวแสง ประเภทนี้ โดยสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูอิเนียมกับลิแกนด์โพลีไพริดีนหรืออนุพันธ์ ของโพลีไพริดีน โดยลิแกนด์โพลีไพริดีนจะมีหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิล (-COOH) เป็นส่วนประกอบของ โมเลกุลและมีความสามารถดูดชับบนพื้นผิวของโลหะออกไซด์ได้ดี ตัวอย่าง สีย้อมไวแสงกลุ่มนี้ ได้แก่ N3 Dye (1) และ Black Dye (2) พบว่าเซลล์สุริยะที่ใช้สีย้อมไวแสงกลุ่มนี้ได้ประสิทธิภาพรวมสูงถึง 10.4% มีค่าใกล้เคียงกับเซลล์สุริยะแบบรอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำ นอกจากนี้ได้มีการพัฒนา สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูอิเนียมกับลิแกนด์โพลีไพริดีน โดยสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน โมเลกุล (3) และ (4) ที่มีหมู่ลิแกนด์ไพร์โรลและไซโอฟีนเพิ่มขึ้นมา ดังรูปที่ 2.11 แม้ว่าการใช้ สารประกอบเชิงซ้อนกลุ่มโลหะรูธิเนียมกับลิแกนด์โพลีไพริดีนจะให้ประสิทธิภาพรวมสูง แต่ยังมี ข้อจำกัดหลายประการ เช่น มีช่วงการดูดกลืนคลื่นแสงอาทิตย์ที่แคบ การสังเคราะห์และทำให้บริสุทธิ์ ยาก และมีราคาแพง จึงมีการศึกษาและทดลองสีย้อมไวแสงนิดอื่น



N3 Dye (1)





รูปที่ 2.11 สีย้อมไวแสงกลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูธิเนียมกับลิแกนด์โพลีไพริดีน [3]

2.6.2 กลุ่มสีย้อมไวแสงสารอินทรีย์

คือการนำสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาสังเคราะห์ใช้เป็นสีย้อมไวแสง สีย้อมไวแสง สารอินทรีย์ชนิดนี้ให้ประสิทธิภาพรวมที่ต่ำกว่ากลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูธิเนียม แต่ยังคง ได้รับความสนใจและศึกษาพัฒนา เนื่องจากสารนั้นมีราคาถูก สังเคราะห์ได้ง่าย และมีความเป็นพิษต่ำ สีย้อมไวแสงสารอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นโมเลกุลที่มีพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวต่อกันยาว และมีหมู่ ฟังก์ชันที่มีความเป็นขั้วสูง เช่น โมเลกุล (5) – (7) เป็นอนุพันธ์ของคูมาริน (coumarin) ดังรูปที่ 2.12 พบว่าให้ประสิทธิภาพรวมประมาณ 7.7% นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สารกลุ่มเพอริลีน ดังรูปที่ 2.13 (perylene dye) (8, 9) พบว่าให้ประสิทธิภาพรวมใกล้เคียงกันกับอนุพันธ์ของคูมาริน



รูปที่ 2.12 สีย้อมไวแสงสารอินทรีย์กลุ่ม เคามาริน [3]



รูปที่ 2.13 สีย้อมไวแสงสารอินทรีย์กลุ่ม เพอริลีน [3]

2.6.3 กลุ่มสีย้อมไวแสงพอร์ไฟริน (porphyrin)

เป็นสีย้อมที่พัฒนามาจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นโครโมฟอร์ที่สำคัญในกระบวนการ สังเคราะห์แสงของพืช ในปี ค.ศ. 1993 Grätzel (Kay et al., 1993) ได้สังเคราะห์อนุพันธ์พอร์ไฟริน โครงสร้างสีย้อมแสดงดังรูปที่ 2.14 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการดูดกลืนแสงบนตัวดูดซับ ไทเทเนียมไดออกไซด์ พบว่าสีย้อมไวแสง Cu-MP ให้ประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 2.6%



รูปที่ 2.14 โมเลกุลของคลอโรฟิลล์และ Cu-MP [3]

ปี ค.ศ.1996 Boschloo และ Goossens ได้พัฒนากลุ่มสีย้อมไวแสงพอร์ไฟริน โดยสังเคราะห์สีย้อม ไวแสงพอร์ไฟริน Zn-TCPP ดังรูปที่ 2.15 พบว่าให้ประสิทธิภาพรวมประมาณ 1.1% ต่อมาในปี ค. ศ. 2000 Cherian และWamser (Cherian and Wamser, 2000) ใช้ TCPP ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ Zn-TCPP แต่ปราศจากโลหะ Zn เป็นโมเลกุลสีย้อมไวแสง พบว่าให้ประสิทธิภาพรวมเพิ่มเป็น 3.5%



รูปที่ 2.15 สีย้อมไวแสงพอร์ไฟริน Zn-TCPP [3]

และต่อมาในปี 2004 (Campbell et al.,, 2004) สังเคราะห์พอร์ไฟริน meso-linkes ซึ่งมีโครงสร้าง ดังรูปที่ 2.16 สาร Zn-1a, Zn-1b และ Zn-1c พบว่าให้ประสิทธิภาพรวมของ Zn-1b สูงถึง 4.2%



รูปที่ 2.16 สีย้อมไวแสงพอร์ไฟริน meso-linkes [3]

ในปี 2011 Aswani Y., และคณะ ได้พัฒนาสีย้อมของกลุ่มพอร์ไฟริน พบว่าได้ประสิทธิภาพรวมของสี ย้อมกลุ่มพอร์ไฟรินมีค่าสูงถึง 12.4 % [5] ซึ่งใกล้เคียงกับสีย้อมกลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูธิ เนียม ดังนั้นการสังเคราะห์สีย้อมไวแสงพอร์ไฟรินสามารถปรับเปลี่ยนหมู่ ฟังก์ชันภายในโมเลกุลได้ ง่ายและมีแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพไปในทางที่สูงขึ้น จึงทำให้ปัจจุบันสีย้อมไวแสงพอร์ไฟริน ยังคงได้รับความสนใจศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาสีย้อม มีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1. สารสีย้อมไวแสงที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วง visible light – IR light เพื่อเพิ่มอิเล็กตรอนในสภาวะเร้าให้ได้มาก 2.เพิ่มความสามารถการยึดติด ของสีย้อมไวแสงกับพื้นผิวโลหะออกไซด์ และ 3.เพิ่มความสามารถในการถ่ายอิเล็กตรอนระหว่าง สี ย้อมไวแสงกับโลหะออกไซด์

2.7 ระบบสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงสูงสุด ชั้นอนุภาคนาโนของสารกึ่ง ตัวนำโลหะออกไซด์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ มีความเสถียรภาพสูง มีพลังงานแถบช่องว่าง (Eg) ที่กว้าง มีพื้นที่ผิวมากเพื่อให้โมเลกุลของสีย้อมยึดเกาะได้มาก มีการกระจายตัวของรูพรุนสม่ำเสมอเพื่อให้ ไอออนของอิเล็กโทรไลต์แพร่ผ่านได้ดี และอนุภาคของสารกึ่งตัวนำต้องเชื่อมติดกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อิเล็กตรอนส่งผ่านได้ดี ในปี 1991 Grätzel และคณะ ได้เลือกอนุภาคผลึกนาโนไทเทเนียมได ออกไซด์ เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีช่องว่างแถบพลังงานกว้างประมาณ 3.2 eV มีความเสถียรภาพสูง มาใช้ ในการเตรียมเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะนั้น สามารถ ทำได้โดยทดลองเปลี่ยนอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นอนุภาคนาโนของสารกึ่งตัวนำที่มี พลังงานแถบช่องว่างชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ZnO₂ WO₃ Fe₂O₃ SrTiO₃ CdS MoS₂ ZnS ZnTe และ CdSe ซึ่งสารจำพวกนี้มีพลังงานแถบช่องว่าง แสดงดังรูปที่ 2.17



รูปที่ 2.17 ค่าพลังงานแถบช่องว่างของสารกึ่งตัวนำ [6]

ฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO₂ Film) [7] ที่มีรูพรุนในรูปผลึกระดับนาโนแบบอนาเทส (anatase) ซึ่งเป็นวัสดุที่เสถียร ราคาถูก ใช้ในเซลล์สุริยะชนิดนี้ได้ดีมาก และไม่เป็นพิษ ชั้นของฟิล์มไททาเนียมได ออกไซด์หรือความหนาของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ยิ่งมีมาก ก็จะมีพื้นที่ผิวมากเพราะความพรุนที่มี มากขึ้นทำให้สีย้อมไวแสงยึดเกาะได้มาก ฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ใช้เคลือบบนกระจกนำไฟฟ้าด้าน ที่สัมผัสแสง (working electrode) ไททาเนียม (titanium) Ti มีเลขอะตอม 22 มีมวลอะตอม 47.867 amu มีจุดหลอมเหลว 1,600.0 ℃ มีจำนวนโปรตอนต่ออิเล็กตรอน 22 ตัว และมีจำนวน นิวตรอน 26 ตัว ซึ่งในตารางธาตุจัดอยู่ในกลุ่มโลหะทรานซิชัน (transition metal) มีโครงสร้างผลึก แบบเฮกซะกอนอล (hexagonal) นั้นมีความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 ℃ ประมาณ 4.54 g/cm³ ลักษณะทางกายภาพมีสีขาวคล้ายเงิน (silver) มีความแข็งแต่ไม่เปราะเมื่อ เทียบกับโลหะทรานซิชัน ด้วยกันและจะมีความหนาแน่นน้อยที่สุดที่อุณหภูมิเดียวกันนั้น ไททาเนียมจะไม่ไวต่อการทำปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิน้อยกว่า 500 ℃ แต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่านี้จะทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับอโลหะอันเป็นผล ให้เกิดสารประกอบไททาเนียมขึ้น

สมบัติเฉพาะของสารประกอบไททาเนียมไดออกไซด์ สารประกอบไททาเนียมไดออกไซด์ เป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำปฏิกิริยาระหว่างโลหะ ทรานซิชันกับอโลหะออกซิเจน โดยสถานะออกซิเดชันของไททาเนียมได้แก่ +2, +3 และ +4 ซึ่งไททา เนียมที่มีสถานะออกซิเดชัน +4 เป็นสถานะเสถียรที่สุดภายใต้สภาวะต่าง ๆ โดยสารประกอบไททา เนียมที่มีสถานะออกซิเดชัน +4 ก็คือไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2)

2.8 ระบบขั้วไฟฟ้าร่วมและแนวทางการพัฒนาระบบ

ขั้วไฟฟ้าร่วมทำหน้าที่ถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่มาจากภายนอกให้กลับเข้าสู่สารละลายอิเล็กโทร ไลต์ โดยที่ขั้วไฟฟ้าร่วมต้องมีคุณสมบัติคือ มีค่าการนำไฟฟ้าที่ดี มีความเป็นรูพรุนสูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว ในการเกิดปฏิกิริยา และต้องเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดี วัสดุที่นิยมใช้ทำเป็นขั้วไฟฟ้าร่วมคือ โลหะ แพลทินัม (Pt) จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยส่วนใหญ่ใช้โลหะแพลทินัม (Pt) หรือ ผงคาร์บอนทำเป็น ขั้วไฟฟ้าร่วมสำหรับเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง โลหะแพลทินัม (Pt) มีโครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์ มีเลขอะตอม 78 น้ำหนักอะตอม 195.07 มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 3,827 °C และ1,769 °C มีสภาพไฟฟ้าลบ 2.28 ความหนาแน่น (300K) g/cm³ : 21.5 มีลักษณะสีเงินเทา มีน้ำหนักมาก สามารถยึดและตีเป็นแผ่นได้ แพลทินัมทนต่อการกัดกร่อนมาก ในธรรมชาติพบอยู่กับสินแร่ของ นิกเกิลและทองแดง ส่วนใหญ่ใช้เป็นอุปกรณ์ในห้องทดลอง ตัวนำไฟฟ้า เป็นต้น

้ส่วนแนวทางในการพัฒนาระบบขั้วไฟฟ้าร่วม เนื่องจากโลหะแพลทินัมมีราคาแพงอาจใช้วัสดุ อื่นแทนได้ เช่น ผงคาร์บอน ท่อคาร์บอนนาโน ผงคาร์บอนแบล็ค พอลิเมอร์นำไฟฟ้า (conducting polymer) เช่น PEDOT:PSS หรือ Polypyrrole และวัสดุเซเลไนด์ เป็นต้น ในปี 2012 Gong F., และ คณะ [8] ได้พัฒนาขั้วไฟฟ้าร่วมในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง โดยขั้วไฟฟ้าร่วมจะใช้วัสดุเซเลไนด์ ้ได้แก่ โคบอลเซเลืไนด์ (Co_{0.85}Se) และ นิกเกิลเซเลไนด์ (Ni_{0.85}Se) ซึ่งวัสดุเซเลไนด์นี้ถูกสังเคราะห์ ้ด้วยขบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิต่ำ พบว่าเซลล์สุริยะทดสอบที่ใช้โคบอลเซเลไนด์เป็นขั้วไฟฟ้า ร่วมให้ประสิทธิภาพรวมมีค่าสูงถึง 9.4 % และนิกเกิลเซเลไนด์ให้ประสิทธิภาพรวม 8.3 % ส่วนโลหะ แพลทินัมให้ประสิทธิภาพรวม 8.6 % ซึ่งขั้วไฟฟ้าร่วมที่ใช้วัสดุเซเลไนด์นั้นใหผลที่ดีเทียบเทากับเซลล ้สุริยะที่ใชโลหะแพลทินัม ต่อมาในปี 2015 ผศ.ดร.มาริสา อรัญชัยยะ [9] ได้ทดลองพัฒนาขั้วไฟฟ้า ร่วมในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง โดยการทดสอบใช้ขั้วไฟฟ้าจากวัสดุที่เตรียมขึ้น 4 แบบ ซึ่งเป็น ้ วัสดุที่สามารถหาและเตรียมได้ง่าย ราคาไม่แพง โดยส่วนประกอบอื่นที่ใช้ในเซลล์สุริยะได้แก่ สี สารประกอบเชิงซ้อนรูธิเนียม (N719) ใช้อิเล็กโทรไลต์กึ่งของแข็งที่ทำจากคอมพอสิทของพอลิเอทิลีน ออกไซด์ ไอโอดีน และโพแทสเซียมไอโอไดด์ ส่วนขั้วไฟฟ้ารับแสงใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ พบว่า ขั้วไฟฟ้าร่วมที่ใช้วัสดุคาร์บอนแบล็คผสมแลนทานัมโคบอลออกไซด์ (carbon black-LaCoO₃), พอลิอะนิลิน (Polyaniline ; PANI) และ พอลิ3,4-เอทิลีนไดออกซีไทโอฟิน (Poly3,4ethylenedioxythiophene; PEDOT) ใหผลที่ดีเทียบเทากับเซลลสุริยะที่ใชโลหะแพลทินัม

2.9 ระบบอิเล็กโทรไลต์และแนวทางการพัฒนาระบบ

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา DSSC ให้มีค่า PCE ได้สูงสุดถึง 11.9% [10] อย่างไรก็ตามเซลล์ ้สุริยะแบบ DSSC ยังคงมีข้อจำกัดในด้านของความคงทน อายุการใช้งาน เนื่องจากมีการใช้ของเหลว เช่น Nal/I2ผสม ethylene carbonate และ acetonitrile เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งมักมีปัญหาด้าน การรั่วซึมและทำให้อายุการใช้งานสั้น แม้ว่าจะมีความพยายามแก้ปัญหาด้วยการใช้ room temperature ionic liquid ซึ่งเป็นสารที่ระเหยได้ยากมาแทน แต่อย่างไรก็ตามสารดังกล่าวยังคงมี ้ลักษณะเป็นของเหลวและอาจเกิดการรั่วซึมได้หากการยึดติดระหว่าง sealing film กับกระจกที่ทำ หน้าที่เป็นชั้นขั้วในเซลล์สุริยะไม่ดีพอ ดังนั้นแนวโน้มของงานวิจัยและพัฒนา DSSC ในระยะถัดมาจึง เน้นไปทางด้านการใช้สารอิเล็กโทรไลต์แบบของแข็งและกึ่งของแข็งแทน เช่น เจลพอลิเมอร์และ hole transport materials ชนิดต่าง ๆ เช่น SpiriOMeTAD, P3HT, หรือ CsSnl₃ เป็นต้น เจลพอลิเมอร์ หรือพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์มีจุดเด่นสำคัญในเรื่องการนำพาไอออนดี และสามารถแข็งตัวได้ง่าย โดย พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์มีลักษณะเป็นเจลที่มีโครงสร้างแบบร่างแหสามมิติ เพื่อเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างอิ เล็กโทรไลต์แบบแข็งและชั้นรูพรุนระดับนาโนโลหะออกไซด์ นอกจากนี้สามารถขึ้นรูปได้ง่ายไม่ ซับซ้อน ในปัจจุบันนิยมใช้ Poly (ethylene glycol) (PEG) และ Poly (ethylene oxide) (PEO) เป็นวัสดุในการเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์และพบว่าการใช้ประโยชน์พอลิเมอร์ร่างแหแบบเจลของ PEO segments ในการทำพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ร่วมสามารถให้ประสิทธิภาพเซลล์สูงสุดเท่ากับ 8.1% [3] ภายใต้แสงอาทิตย์จำลอง ความเข้มแสง AM 1.5 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้สารอิเล็กโทร ไลต์แบบกึ่งของแข็งจะสามารถช่วยยึดอายุการใช้งานของเซลล์ดังกล่าวได้แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะจะลดลง เมื่อเทียบกับเซลล์สุริยะที่ใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์เหลว

2.10 พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์

พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ คือ การใช้พอลิเมอร์เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งโดยทั่วไปสารอิเล็กโทร ไลต์แบบของแข็งที่ทำจากพอลิเมอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก [11] ได้แก่ 1.วัสดุพอลิเมอร์ใน สถานะของแข็ง (solid state polymer electrolyte), 2.วัสดุพอลิเมอร์ในสถานะกึ่งของแข็ง (polymer gel electrolyte หรือ quasi-solid state polymer electrolyte) , 3.วัสดุเชิงประกอบ พอลิเมอร์ที่มีการเติมสารเติม (fillers) บางชนิดลงไป

 วัสดุพอลิเมอร์ในสถานะของแข็ง เช่น พอลิเอธิลีนไกลคอล (PEG) ผสมกับสารอิเล็กโทรไลต์เช่น LiCLO₄ หรือ I₂/Nal โดยปราศจากตัวทำละลายและสารเสริมสภาพพลาสติก (plasticizer) ซึ่ง PEG จะทำหน้าที่เป็นเมตริกหลัก และอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (lone-pair electron) ของออกซิเจนสร้าง พันธะกับไอออนบวกของโลหะ โดยไอออนบวกของโลหะสามารถเคลื่อนที่อยู่ภายใน PEG ที่มี โครงสร้างแบบเกลียว (helical conformation) ได้ แสดงดังรูป 2.18



รูปที่ 2.18 ลักษณะการเคลื่อนที่ของไอออนลิเธียมผ่านตัวกลางพอลิเมอร์ชนิด PEO [12]
2. วัสดุพอลิเมอร์ในสถานะกึ่งของแข็ง (polymer gel electrolyte หรือ quasi-solid state polymer electrolyte) ระบบจะอาศัยพอลิเมอร์ทำหน้าที่เป็นเจล (gelator) ผสมกับสารอิเล็กโทร ไลต์เช่น LiClO₄ และยังมีการเติมตัวทำละลายลงไปด้วยเพื่อที่จะลดความเป็นผลึกและเพิ่ม ความสามารถในการนำไอออนให้กับสารพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ ตัวอย่างของพอลิเมอร์ที่ใช้เป็นเจลใน สารอิเล็กโทรไลต์ เช่น พอลิเมอร์ในตระกูลพอลิอะคริเลต พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF) พอลิไว นิลลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF) พอลิไว นิลลิดีนฟลูออไรด์-เฮกซะฟลูออโรโพรพิลีน โคพอลิเมอร์ P(VDF-HFP) พอลิเอธิลีนออกไซด์ (PEO) และพอลิโพรพิลีนออกไซด์ (PPO) เป็นต้น

 วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ที่มีการเติมสารเติม (fillers) บางชนิดลงไป ประเภทที่ active (เกิดปฏิกิริยาและมีส่วนร่วมในการนาประจุ) เช่น เช่น Li₃N, **γ**-LiAlO₂ และประเภทที่ไม่ active เช่น ออกไซด์ของ เซรามิก Al₂O₃, TiO₂, ZrO₂ และวัสดุเฟอโรอิเล็กตริก (BaTiO₃)

2.11 การวัดประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

(ก) อัตราส่วนมวลอากาศ

โดยทั่วไปการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะจะอ้างอิงจากค่าอัตราส่วนมวลอากาศ (Air Mass) AM = 1/cos Θ_z โดยที่ Θ_z หรือมุม Zenith คือมุมที่กระทำกับเส้นตั้งฉากจากดวงอาทิตย์ มายังโลก ค่า AM จะมีค่ามากที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์ทำมุม 0 องศากับพื้นโลก สเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย์ ณ ตำแหน่งที่มีค่าอัตราส่วนมวลอากาศ AM = 1.5 หรือ มุม Θ_z = 48.2 องศา แสดงดังรูปที่ 2.19 ซึ่งเทียบได้กับค่าความเข้มรังสีของแสงหรือกำลังไฟฟ้าที่ตกกระทบบนพื้นที่ของเซลล์สุริยะมี ค่าประมาณ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ถือเป็นค่าเฉลี่ยของสเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีของ พื้นผิวโลกในทุกระดับละติจูด (Mid-latitudes) และใช้เป็นสเปกตรัมมาตรฐานสำหรับเครื่องกำเนิด แสงอาทิตย์เทียม (Sun simulator) ในการทดสอบเซลล์สุริยะ [13]



รูปที่ 2.19 สเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย์ AM 0.0 และ AM 1.5 [14]

(ข) ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะที่ขึ้นกับความยาวคลื่นแสง

ค่าประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะที่ขึ้นกับความยาวคลื่นแสง โดยประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลง พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า (Incident Photon to Current Conversion Efficiency, IPCE) หรือประสิทธิภาพควอนตัมภายนอก สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.1

IPCE (λ) =
$$\frac{1240 \cdot J_{sc} (A/cm^2)}{\lambda (nm) \cdot I_{inc} (W/cm^2)}$$
 ສມຄາຮ (2.1)

โดยที่ J_{sc} (short circuit current density) คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าลัดวงจรต่อหนึ่งหน่วย พื้นที่โฟโตอิเล็กโทรด, λ คือความยาวคลื่นแสงที่ตกกระทบเซลล์สุริยะ, $I_{
m inc}$ คือ ความเข้มแสงที่ตก กระทบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่โฟโตอิเล็กโทรด

(ค) ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะ

ค่าประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะ (**ท**) เป็นพารามิเตอร์หลักที่ใช้บอกถึงประสิทธิภาพการ เปลี่ยนรูปพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์สุริยะซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ (2.2) และ (2.3)

$$\eta(\%) = \frac{P_{max}}{P_{in}} \times 100$$
 สมการ (2.2)

$$\eta(\%) = \frac{I_{max} \times V_{max}}{P_{in}} \times 100$$
 สมการ (2.3)

โดยที่ P_{max} คือ กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่แสงอาทิตย์จ่ายให้กับวงจรภายนอก

P_{in} คือ กำลังไฟฟ้าของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนเซลล์สุริยะ

- I_{max} คือ ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด
- V_{max} คือ ค่าศักย์ไฟฟ้าสูงสุด

ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ (Fill Factor, FF) คือค่ามาตรฐานของการวัดคุณภาพของตัวเซลล์ ซึ่ง หมายถึงค่าฟิลล์แฟกเตอร์จะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สร้างจาก I_{max} คูณ V_{max} ต่อพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สร้างจาก I_{sc} คูณ V_{oc} แสดงดังรูป 2.20 ถ้าค่า FF ยิ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่า เป็นแบบในอุดมคติหมายถึงค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรกับค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิดเท่ากับค่ากระแสไฟฟ้า สูงสุดกับค่าศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์สุริยะที่ทำได้ แต่ถ้าค่า FF ต่ำกว่า 1 มาก และให้ค่ากระแสไฟฟ้า ลัดวงจรกับค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิดสูง แสดงว่าค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดกับค่าศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์ สุริยะที่ทำได้มีค่าต่ำ เนื่องจากเซลล์สุริยะนั้นมีความต้านทานอนุกรมภายนอกเซลล์สูงเกินไปหรือมี ความต้านทานชันท์ภายในเซลล์ต่ำเกินไป ส่งผลให้เซลล์สุริยะผลิตกระแสไฟฟ้ากับศักย์ไฟฟ้าได้น้อย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

$$FF = \frac{I_{max} \times V_{max}}{I_{sc} \times V_{oc}}$$

สมการ (2.4)

โดย I_{sc} คือ ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (short circuit current)

V_{oc} คือ ค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด (open circuit voltage)



รูปที่ 2.20 วิธีการหาค่าฟิลล์แฟกเตอร์ของเซลล์สุริยะ

จากสมการที่ (2.3) และสมการที่ (2.4) สามารถเขียนใหม่รวมกันได้เป็นสมการประสิทธิภาพของเซลล์ สุริยะ โดยกราฟลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (I-V curve) ของเซลล์สุริยะจะ แสดงดังรูปที่ 2.21



รูปที่ 2.21 ลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (I-V curve) ของเซลล์สุริยะ

2.12 วงจรสมมูลของเซลล์สุริยะ [15]

เซลล์สุริยะสามารถแทนด้วยวงจรสมมูล (Equivalent Circuit) แสดงดังรูปที่ 2.22 เริ่มจาก แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อขนานกับไดโอด และตัวต้านทานชันท์ (R_{sh}) จากนั้นต่ออนุกรมกับตัว ต้านทานอนุกรม (R_s) โดยกำหนดแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกระแสคงที่และแปรผันตามความ เข้มแสง ซึ่งความต้านทานอนุกรมเป็นค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นจากจุดเชื่อมต่อ (Wiring Contact) ระหว่างตัวนำไฟฟ้ากับตัวเซลล์ ส่วนความต้านทานชันท์เกิดขึ้นเมื่อให้แรงดันไฟฟ้าในลักษณะไบแอส ย้อนกลับให้กับไดโอด

ผลลัพธ์ของกระแสที่ได้จากเซลล์สุริยะ เกิดมาจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์หักลบด้วยกระแสที่ไหล ผ่านไดโอด และผ่านความต้านทาน Shunt ขณะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดค่าแรงดันไฟฟ้าแต่ละ จุดขึ้น ซึ่งแสดงสมการที่ (2.6)



สมการ (2.6)

รูปที่ 2.22 แบบจำลองวงจรมูลของเซลล์สุริยะ

สมการที่ (2.7) แสดงแรงดันไฟฟ้า ณ จุดใด ๆ

โดยที่ I คือ กระแสไฟฟ้าขาออก มีหน่วยเป็นแอมแปร์

IL คือ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งพลังงานแสง มีหน่วยเป็นแอมแปร์

ID คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไดโอด มีหน่วยเป็นแอมแปร์

- I_{SH} คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานชันท์ มีหน่วยเป็นแอมแปร์
- V คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก มีหน่วยเป็นโวลต์
- V_i คือ แรงดันไฟฟ้า ณ จุด ใด ๆ มีหน่วยเป็นโวลต์
- R_s คือ ความต้านทานอนุกรม มีหน่วยเป็นโอห์ม

พารามิเตอร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะได้แก่ กระแสลัดวงจร (I_{sc}) ศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด (V_{oc}) และฟิลล์แฟกเตอร์ (FF) รูปที่ 2.23 กระแสลัดวงจรคือกระแสไฟฟ้าขณะที่แรงดันไฟฟ้าของ เซลล์สุริยะมีค่าเป็นศูนย์ จึงเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด และแรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีกระแสเป็นค่า แรงดันไฟฟ้าสูงสุด ส่วนค่าฟิลล์แฟกเตอร์เป็นอัตราส่วนระหว่างผลคูณ แรงดันกับกระแสที่จุดทำงาน สูงสุด และผลคูณของกระแสลัดวงจรกับแรงดันวงจรเปิดซึ่งมีค่าน้อยกว่าหนึ่ง นอกจากนี้มีพารามิเตอร์ เกี่ยวกับความต้านทานในเซลล์สุริยะต้องศึกษาและการพัฒนา โดยคิดจากสัดส่วนระหว่างค่าแรงดัน ที่สุดสูงสุดต่อกระแสที่สูงสุด หรืออาจใช้สัดส่วนระหว่างค่าแรงดันวงจรเปิดต่อกระแสลัดวงจร



รูปที่ 2.23 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะ

2.13 ปัจจัยที่ลดทอนประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะ

ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะขึ้นกับปัจจัยภายในเซลล์และภายนอกเซลล์ เช่น ความเข้มรังสีอาทิตย์ อุณหภูมิ ความต้านทานชันท์ และความต้านทานอนุกรมเป็นต้น (ก) ผลของความเข้มรังสีอาทิตย์ ตัวอย่างผลกระทบจากความเข้มรังสีอาทิตย์ เซลล์สุริยะเซลล์
 เดียวกันแต่วัดที่ความเข้มแสงที่ต่างกันคือ 1.5 และ 1.0 อาทิตย์ ดังรูปที่ 2.24 และ รูปที่ 2.25 [16]



รูปที่ 2.24 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะที่ความเข้มแสง 1.5 อาทิตย์



รูปที่ 2.25 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะที่ความเข้มแสง 1.0 อาทิตย์

พบว่าที่ความเข้มรังสีอาทิตย์มีค่าน้อย เนื่องจากในวันที่ท้องฟ้ามืดครึม มีเมฆบดบัง หรือการบังเงา เนื่องจากต้นไม้ เป็นต้น ทำให้ค่ากระแสลัดวงจรหรือกระแสสูงสุดจะลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพของ เซลล์สุริยะลดลง (ข) ผลของอุณหภูมิ ผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะลดลง
 เนื่องจากสภาวะที่อุณหภูมิสูงระยะห่างของแถบพลังงานจะลดลง เป็นผลให้แรงดันขาออกของเซลล์
 สุริยะมีค่าน้อยลงแต่ไม่ส่งผลให้กระแสลัดวงจรเปลี่ยนแปลงมาก ดังรูปที่ 2.26



รูปที่ 2.26 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะต่ออุณหภูมิ

(ค) ความต้านทานอนุกรม (R_s) และความต้านทานชันท์ (R_{sh})



รูปที่ 2.27 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะต่อความต้านทานอนุกรม



รูปที่ 2.28 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของเซลล์สุริยะต่อความต้านทานชันท์

ความต้านทานอนุกรมมีค่าเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าแรงดันขาออก (V_{max}) มีค่าลดลง ซึ่งจะทำให้ค่าฟิลล์แฟก เตอร์มีค่าลดลงตาม แต่จะไม่มีผลต่อค่าแรงดันวงจรเปิด (V_{oc}) ถ้าความต้านทานมีค่ามากเกินไปจะทำ ให้ค่ากระแสลัดวงจรมีค่าลดลงและลักษณะของกราฟ IV จะกลายเป็นเส้นตรง แสดงดังรูปที่ 2.27 ส่วนความต้านทานชันท์มีค่าน้อยจะทำให้ค่าแรงดันวงจรเปิดและค่ากระแสลัดวงจรมีค่าลดลง และจะ ส่งผลให้ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ลดลงและลักษณะกราฟ IV จะมีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีของความ ต้านทานอนุกรม แสดงดังรูปที่ 2.28

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.14 เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิงเคมีไฟฟ้า (Electrochemical Impedance Spectroscopy: EIS)

เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเซิงเคมีไฟฟ้าหรืออิมพีแดนซ์ของไฟฟ้ากระแสสลับ [17] (AC impedance) ได้ถูกนำมาประยุกต์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการที่เกิดขึ้นบริเวณขั้วไฟฟ้าและหน้าสัมผัส ที่มีความซับซ้อน (Complex interface) หลักการพื้นฐานของเทคนิคอิมพีแดนซ์ คือการป้อน สัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นคลื่นรูปไซน์ (Sinusoidal wave) ที่มีแอมพลิจูดต่ำเข้าสู่ระบบและวัดสัญญาณ ตอบสนอง สัญญาณกระตุ้นที่นิยมใช้สำหรับเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิงเคมีไฟฟ้ามี 3 แบบ ได้แก่ 1. การป้อนสัญญาณกระตุ้นในรูปของศักย์ไฟฟ้าขั้นบันได (Step function) คือป้อนศักย์ไฟฟ้า V (t) = V₀ ที่เวลา t > 0 และป้อนศักย์ไฟฟ้า V (t) = 0 ที่เวลา t < 0 และวัดสัญญาณตอบสนองที่เวลาต่าง ๆ วิธีการนี้สามารถทำได้ง่ายและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่ผิวรอบต่อจะถูกควบคุมด้วย

ศักย์ไฟฟ้า การวิเคราะห์ค่าอิมพีแดนซ์ที่ได้จะค่อนข้างยากเนื่องจากไม่มีการควบคุมสเปกตรัมที่ความถี่ ต่าง ๆ นอกจากนี้ต้องนำผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ฟูเรียร์ (Fourier analysis) จึงทำให้การวิเคราะห์ทำได้ยากขึ้น

 การป้อนสัญญาณในรูปศักย์ไฟฟ้า V (t) ซึ่งประกอบด้วยสัญญาณรบกวนไวต์ (white noise) แบบ สุ่มที่ระยะเวลาสั้น ๆ และวัดกระแสตอบสนอง วิธีการนี้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก มีการป้อนสัญญาณเพียงหนึ่งสัญญาณ แต่ต้องใช้สัญญาณรบกวนไวต์ที่เหมาะสมและต้องวิเคราะห์ค่า อิมพีแดนซ์ที่ได้ด้วยการวิเคราะห์ฟูเรียร์

 การป้อนสัญญาณในรูปของศักย์ไฟฟ้าที่ความถี่ค่าหนึ่งและวัดแอมพลิจูดและมุมเฟส (Phase) หรือ ส่วนจริง (Real part) และส่วนจินตภาพ (Imaginary part) ของกระแสไฟฟ้าความถี่นั้น ๆ วิธีการนี้ เป็นวิธีที่ง่ายแล้วนิยามใช้กันมากที่สุด

เริ่มแรกการวัดอิมพีแดนซ์จะวัดภายใต้การจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแอมปลิจูดน้อย ๆ เข้าไป การวัดจะ วัดออกมาที่ความถี่ต่าง ๆของไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีศักย์ไฟฟ้าเป็น ฟังก์ชันไซน์ (sinusoidal potential) มากระทำกับสารจึงทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเป็นฟังก์ชัน ไซน์ (sinusoidal current) แต่จะมีเฟสที่ต่างกับศักย์ไฟฟ้า ดังสมการ (2.8) และสมการ (2.9) รูปที่ 2.29



เมื่อ V(t) คือ ศักย์ไฟฟ้าที่เวลา t ใด ๆ

- V_0 คือ แอมปลิจูดของศักย์ไฟฟ้า
- I(t) คือ กระแสไฟฟ้าที่เวลา t ใด ๆ
- $\mathbf{I_0}$ คือ แอมปลิจูดของกระแสไฟฟ้า
- ω คือ อัตราเร็วเชิงมุม
- Ø คือ ความต่างเฟส
- t คือ เวลาใด ๆ



รูปที่ 2.29 ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าฟังก์ชันไซน์ในวงจรกระแสสลับที่มีความต่างเฟส $oldsymbol{\emptyset}$

จากกฎของโอห์ม Z สามารถเขียนได้ดังสมการ (2.10)

 $Z = \frac{V(t)}{I(t)} = \frac{V_0 \cos(\omega t)}{I_0 \cos \omega \phi} = Z_0 \frac{\cos \omega t}{\cos \omega \phi} = Z_0 \exp(i\phi) = Z_0(\cos\phi + i\sin\phi)$

สมการ 2.10 เมื่อ \mathbf{Z}_{0} คือ อัตราส่วนของแอมปลิจูดของศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า

จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานเชิงซ้อน Z จะขึ้นอยู่กับค่าแอมปลิจูดของศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อัตราเร็วเชิงมุม และความต่างเฟส ซึ่งเป็นจำนวนเชิงซ้อน สำหรับค่า Z ในเซลล์ไฟฟ้า เคมีนั้น เมื่อนำ ส่วนจริง (real part) มาพล็อตในแกน x และส่วนจินตภาพ (imaginary part) มา พล็อตในแกน y จะได้กราฟที่เรียกว่า Nyquist plot โดยที่แกน y จะเป็นค่าลบและแต่ละจุดของ กราฟจะแทนค่า Z ที่ความถี่ต่าง ๆ ดังรูปที่ 2.30

Ghulalongkorn University



รูปที่ 2.30 a) Nyquist plot ของวงจร และ b) วงจรตัวต้านทานขนานกับตัวเก็บประจุ

สำหรับการประยุกต์ใช้เทคนิคอิมพีแดนซ์ในการศึกษาความต้านทานภายในของ DSSCs นั้น ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างมากเพื่อศึกษาความต้านทานของหน้าสัมผัสในส่วน สารกึ่งตัวนำ สีย้อม อิเล็กโทรไลต์ และความต้านทานของหน้าสัมผัสระหว่างแพลทินัมกับอิเล็กโทรไลต์ เป็นต้น โดยใช้ ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีค่าแอมปลิจูดต่ำ ๆ ซึ่งตามทฤษฎีจะทำให้ได้ Nyquist plot ที่ประกอบไปด้วย ครึ่งวงกลมสามวงเรียงต่อกัน แต่ละครึ่งวงกลมแสดงถึงการถ่ายเทประจุในแต่ละส่วนของเซลล์ ในช่วง ความถี่สูงแสดงถึงการถ่ายเทประจุบริเวณเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด ช่วงความถี่ปานกลางแสดงถึงการ ถ่ายเทประจุบริเวณสารกึ่งตัวนำและช่วงความถี่ต่ำ แสดงถึงการถ่ายเทประจุภายในอิเล็กโทรไลต์ แต่ ในบางครั้งครึ่งวงกลมที่ความถี่ต่ำอาจถูกกลืนไปด้วยครึ่งวงกลมความถี่ปานกลาง กราฟ Nyquist plot ที่จ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ 0.7 โวลต์ ประกอบด้วยความต้านทานในแนวแกน x และ ความต้านทานเชิงซ้อนของตัวเก็บประจุในแนวแกน y ซึ่งความต้านทานในแกน x นั้นแต่ละช่วงความถี่ เป็นความต้านทานในแต่ละส่วนของหน้าสัมผัสในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง แสดงดังรูปที่ 2.31 และ รูปแบบวงจรสำหรับการฟิตดิ้งผลการทดลอง EIS แสดงดังรูปที่ 2.32



รูปที่ 2.31 แสดง Nyquist plot ทั่วไปของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง



รูปที่ 2.32 รูปแบบวงจรสำหรับการฟิตติ้งผลการทดลอง EIS

ค่าความต้านทานในแต่ละช่วงความถี่ของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง โดยสามารถเขียนค่าความ ต้านทานได้ 4 ค่า ได้แก่ ค่า R1 คือค่าความต้านทานเริ่มต้นของกระจกที่เคลือบด้วยสารนำไฟฟ้า (FTO) ช่วงความถี่ประมาณ 1 MHz, ค่า R3 คือค่าความต้านทานของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่บริเวณ หน้าสัมผัสระหว่างโลหะแพลทินัมกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์เหลว (CE/EL) ช่วงความถี่สูงประมาณ 1-100 kHz, ค่า R2 คือค่าความต้านทานของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่บริเวณหน้าสัมผัสระหว่างสาร กึ่งตัวนำไทเทเนียมไดออกไซด์กับสารละลายอิเล็กโทรไลต์เหลว (TiO₂/EL) ช่วงความถี่ประมาณ 1-100 Hz และค่า W1 คือค่าความต้านทานของสารละลายอิเล็กโทรไลต์เหลว (Warburg resistance) ซึ่งอยู่ในช่วงความถี่ต่ำประมาณ 100 mHz ค่าความต้านทานของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง ณ บริเวณหน้าสัมผัสของทั้ง 4 ค่าที่กล่าวมาข้างต้น แสดงดังรูปที่ 2.33



รูปที่ 2.33 ค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสัมผัสและค่าความต้านทานของสารอิเล็กโทรไลต์

HULALONGKORN UNIVERSITY

2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Songyuan และคณะ [18] ได้ศึกษาผลของการออกแบบเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงรูปแบบแถบ ขนาดพื้นที่รับแสง 10.2 cm² และรูปแบบโมดูลขนาดพื้นที่รับแสง 187.2 cm² จากการทดสอบ ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะทั้ง 2 รูปแบบ พบว่าการออกแบบเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงให้มีพื้นที่ รับแสงมากขึ้นทำให้ค่า Fill Factor (FF) ของเซลล์สุริยะลดลงจาก 68.4% เป็น 59% ค่าประสิทธิภาพ การเปลี่ยนรูปพลังงาน (Power Conversion Efficiency: PCE) ลดลงจาก 7.4% เป็น 5.9% และค่า ความหนาแน่นกระแสวงจรปิด (J_{sc}) ลดลงจาก 15.4 mA/cm² เป็น 13.4 mA/cm² เนื่องมาจาก เซลล์สุริยะแบบโมดูลมีความว่องไวต่อความต้านทานของแถบเชื่อมกระแส (Silver bus-bar และ Silver finger) Kim H. และคณะ [19] ได้ออกแบบรูปแบบสำหรับเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงขนาดใหญ่และแบบ มอดูลสำหรับใช้เป็น building-integrated photovoltaic (BIPV) เริ่มต้นได้ประกอบเซลล์ทดสอบ ขนาดเล็ก (9 x 5 mm) โดยใช้เทคนิค EIS (electrochemical impedance spectroscopy) และวัด ค่าคุณสมบัติเชิงแสงและคุณสมบัติทางไฟฟ้า ซึ่งวงจรพื้นฐานของเซลล์สุริยะมาตรฐานถูกสร้างขึ้นใน หน่วยเซลล์ เพื่อนำไปสร้าง 2-dimensional โมเดลวงจรสมมูลของเซลล์สุริยะมอดูลขนาดใหญ่ชนิด Z-type (ขนาด 300 x 300 mm) พบว่าจากโปรแกรม simulation ที่ใช้ออกแบบตัวเซลล์มอดูลให้ ประสิทธิภาพโดยรวม 3.3% และให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อปีอยู่ที่ 448 กิโลวัตต์/ตร.ม. แบบจำลอง ที่พัฒนาขึ้นมานี้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการทำงานของเซลล์สุริยะมอดูลขนาดใหญ่ภายใต้ สภาพแวดล้อมตามบริเวณท้องถิ่น

Escalante R. และคณะ [20] งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการสร้างเซลล์สุริยะที่มีขนาดพื้นที่รับแสง 0.5 cm² ให้มีประสิทธิภาพโดยรวมสูง และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขยายขนาดเซลล์สุริยะแบบมอดูลที่มีขนาด 6 x 8 cm² พบว่าเซลล์สุริยะที่มีขนาดพื้นที่รับแสง 0.5 cm² ให้ประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ 7.8% ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 15 mA/cm² ค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด 0.75 V และค่า Fill Factor 69% ในการขยายขนาดของเซลล์สุริยะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นควรให้ความสำคัญกับความต้านทาน ภายนอกของเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้านทานของกระจกนำไฟฟ้า transparent conducting oxide substrate (FTO) และหนึ่งในขึ้นตอนที่ถูกใช้สำหรับการประกอบเซลล์สุริยะมีขนาดพื้นที่รับ แสง 0.5 cm² ให้ประสิทธิภาพโดยรวมสูงนั้นคือการกระตุ้น FTO (the activation of FTO) พบว่า เซลล์สุริยะให้ประสิทธิภาพดีขึ้นจากเดิม 5% เป็น 7.8% ซึ่งเราจะนำชั้นตอน activation นี้ไปใช้ใน การประกอบเซลล์สุริยะที่มีขนาดใหญ่ จากผลทดลองสรุปได้ว่าระยะห่างระหว่างตัวรวมกระแสไฟฟ้า (silver lines) 2 อัน เพิ่มมากขึ้นทำให้เซลล์ทดสอบที่มีขนาดพื้นที่รับแสง 0.5 cm² มีค่า Fill factor ที่ลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมต่ำลง ส่วนเซลล์สุริยะที่มีขนาดใหญ่แบบมอดูลที่มีการใช้ตัวรวม กระแสไฟฟ้า เบื้องต้นพบว่าให้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 111 mA

Jinbiao J. และ คณะ [21] ได้ศึกษาผลของการใช้ Nickel selenide (Ni_{0.85}Se) เพื่อนำมาใช้แทน แพลททินัมในส่วนขั้วไฟฟ้าร่วมของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาทางด้านต้นทุนใน การผลิตเนื่องจากแพลททินัมนั้นมีราคาแพง Ni_{0.85}Se ที่เตรียมได้มีขนาดอนุภาค 200 นาโนเมตร ลักษณะโครงสร้างที่เป็นรูพรุน ดังนั้น Ni_{0.85}Se เมื่อนำมาใช้เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อม ไวแสงจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นของไตรโอไดด์ไอออนและช่วยเพิ่มค่าการเร่ง ปฏิกิริยาของตัวนำไฟฟ้า จากการทดสอบค่าประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สุริยะ พบว่าเซลล์ DSSC ที่ใช้ Ni_{0.85}Se เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมวัดค่าความต่างศักย์วงจรเปิด(V_{oc}) เป็น 0.78 V ค่าความ หนาแน่นกระแสวงจรปิด(J_{sc}) เป็น 16.39 mA/cm² และค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงาน 8.88% ส่วนเซลล์ DSSC ที่ใช้แพลททินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วมวัดค่าความต่างศักย์วงจรเปิด(V_{oc}) เป็น 0.79 V ค่าความหนาแน่นกระแสวงจรปิด(ปีน 15.55 mA/cm² และค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงาน 8.13% แสดงให้เห็นว่าเซลล์DSSC ที่ใช้ Ni_{0.85}Se เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงาน 8.13% แสดงให้เห็นว่าเซลล์ก่างของขั้วไฟฟ้าร่วม นอกจากนั้นเซลล์ DSSC ที่ใช้Ni_{0.85}Se เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม 8.13% แสดงให้เห็นว่าเซลล์กางของขั้วไฟฟ้าร่วม(Ni_{0.85}Se/mirror) วัดค่าความต่างศักย์ วงจรเปิดเป็น 0.791 V ค่าความหนาแน่นกระแสวงจรปิดเป็น 18.44 mA/cm² และค่าประสิทธิภาพ การเปลี่ยนรูปพลังงาน 10.19% แสดงให้เห็นว่าเซลล์ DSSC ที่ใช้ Ni_{0.85}Se/mirror เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม ทำให้ได้ค่าความหนาแน่นกระแสวงจรปิดและค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานสูงขึ้นเนื่องจาก Ni_{0.85}Se เป็นส่วนที่มีความโปร่ใส่สูงและทำให้แสงสะท้อนมากขึ้นจากการใช้กระจกสะท้อน

Gong F., และคณะ [8] ได้พัฒนาขั้วไฟฟ้าร่วมในเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง โดยขั้วไฟฟ้าร่วมจะใช้ วัสดุเซเลไนด์ ได้แก่ โคบอลเซเล็ไนด์ (Co_{0.85}Se) และ นิกเกิลเซเลไนด์ (Ni_{0.85}Se) ซึ่งวัสดุเซเลไนด์นี้ถูก สังเคราะห์ด้วยกระขบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิต่ำ พบว่าเซลล์สุริยะทดสอบที่ใช้โคบอลเซเล ในด์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมให้ประสิทธิภาพรวมมีค่าสูงถึง 9.4 % และนิกเกิลเซเลไนด์ให้ประสิทธิภาพรวม 8.3 % ส่วนโลหะแพลทินัมให้ประสิทธิภาพรวม 8.6 % ซึ่งขั้วไฟฟ้าร่วมที่ใช้วัสดุเซเลไนด์นั้นใหผลที่ดี เทียบเทากับเซลลสุริยะที่ใชโลหะแพลทินัม

Nagaraj P. และ คณะ [22] ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง โดยใช้เจ ลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ (Gel Polymer Electrolyte; GPE) แทนอิเล็กโทรไลต์เหลว (Liquid Electrolyte) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการรั่วซึมของอิเล็กโทรไลต์เหลว เจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ใน งานวิจัยนี้คือ Poly (ethylene oxide) และ Li/I₂ โดยมีการผสมสาร Acetamide ตามปริมาณที่ กำหนด เป็น 0%, 2%, 4%, 5%, 6% และ 8%โดยน้ำหนัก จากการทดสอบค่าประสิทธิภาพการ ทำงานของเซลล์สุริยะพบว่าเจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ที่มีการผสมปริมาณ Acetamide 5% โดย น้ำหนักให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุด (V_{oc}= 744 mV, J_{sc} =19.81 mA/cm², FF = 0.52 และ PCE = 9.01%) ในการเพิ่มสาร Acetamide ลงใน GPE ทำให้ค่าความหนาแน่นกระแสวงจรปิด ค่าความต่าง ศักย์วงจรเปิดและค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานเพิ่มขึ้น เพราะการเพิ่มสาร Acetamide ลง ใน GPE ทำให้โครงสร้างสัณฐานของ GPE เกิดการเปลี่ยนแปลงและปริมาตรช่องว่างใน GPE เพิ่มมาก ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของไตรโอไดด์และค่าการเหนี่ยวนำของไอออนเพิ่มขึ้นเพราะ เกิดปฏิกิริยาของ PEO (Polyethylene oxide) กับ Acetamide ทำให้ความเป็นผลึกของสายโซ่พอลิ เมอร์ลดลง แต่เมื่อเพิ่มสาร Acetamide มากเกินไปจะทำให้ค่าความหนาแน่นกระแสวงจรปิด ค่า ความต่างศักย์วงจรเปิดและค่าประสิทธิ์ภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานลดลงเนื่องจากเกิดการก่อตัวของ สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างไตรโอไดด์ไอออนและ Acetamide

Ananathraj G. และคณะ [23] ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง แบบกึ่งของแข็ง โดยใช้เจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไสต์ที่เสถียร คือpolyethylene oxide) (PEO) กับpoly (ethylene glycol) (PEG) ในการเตรียมเจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ใช้ PEO กับ PEG ที่มีการใช้ alkali iodides (Lil, Nal or KI) อย่างใดอย่างหนึ่ง เพิ่มสาร 1,2-dimethyl-3-propyl imidazolium iodide (DMPI), 4-tertbutylpyridine (TBP) และ iodine โดยใช้สาร acetonitrile เป็นตัวทำละลาย นำเจลพอลิเมอร์ที่เตรียมได้นั้นไปศึกษาค่าการเหนี่ยวนำไอออนและค่าสัมประสิทธ์การแพร่ของไตรไอ โอไดด์ไอออนในเจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ ซึ่งวัดได้ด้วยเทคนิค Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) พบว่าเซลล์ DSSC ที่ใช้เจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ (PEO-PEG) ที่มีการใช้ Nal ให้ค่าประสิทธิภาพโดยรวม (PCE) 5.4% และเมื่อใช้ nanocrystalline TiO₂ เป็นตัว filler ในเจลพอ ลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ (PEO-PEG) พบว่าทำให้ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเซลล์ทดสอบเพิ่มขึ้นเป็น PCE 6.3% ส่วนความเสถียรภาพของเซลล์สุริยะที่ใช้เจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลด์ (PEO-PEG) นั้นพบว่า สามารถใช้งานเซลลสุริยะได้ประมาณ 600 ชั่วโมง ภายใต้สภาวะแวดล้อม

บทที่ 3 เครื่องมือและวิธีการทดลอง

3.1 สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย

- อะเซตาไมด์ (Acetamide), ~99% (GC), Sigma-aldrich
- พอลิเอทิลีน ออกไซด์ (Polyethylene oxide), Mw ~100,000 Powder, Sigma-aldrich
- โพรพิลีนคาร์บอเนต (Propylene carbonate), Anhydrous 99.7%, Sigma-aldrich
- นิกเกิลคลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต (NiCl_2.6H_2O), ReagentPlus, Sigma-aldrich
- โซเดียมซีลีไนต์ เพนตะไฮเดรต (Na₂Se₃.5H₂O), ≥ 99.0% (RT), Sigma-aldrich
- ไฮดราซีนไฮเดรต (Hydrazine hydrate), reagent grade N_2H_450 -60%, Sigma-aldrich
- โซเดียมไอโอไดด์ (Sodium iodide)
- เกล็ดไอโอดีน (Iodine Resublimed)
- กรดคลอโรแพลตินิก [Hexachloroplatinic (IV) Acid], Merck, Germany.
- ไทเทเนียมไดออกไซด์ [Titanium (IV) chloride], Merck, Germany.
- ที-บิวทิลแอลกอฮอล์ (Tert-Butyl Alcohol), Panreac.
- ไอโซโพรพานอล (2-Propanol), A.R. Grade, Qrec.
- เอทานอล (Ethanol Absolute), A.R. Grade, Qrec.
- เอทานอล (Ethanol), commercial 96%, Alcoh-A.
- อะซีโตไนไตรล์ (Acetonitrile), A.R. Grade, Lab-scan, Thailand.
- สีย้อมไวแสง [Z907 Hydrophobic Dye (C₄₂H₅₂N₆O₄RuS₂)], Dyesol.
- สารละลายอิเล็กโทรไลต์ [EL-HPE High Performance Electrolyte (I-/I3-)], Dyesol.
- ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide), P25, Qrec.
- สีเพ้นท์เงิน (Silver paste)

3.2 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย

- กระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า (TEC15 Conductive glass plates), Dyesol.

- แผ่นเทอร์โมพลาสติก (Surlyn), 60 µm thickness.
- เทปกาวสองหน้า (Adhesive tape)

3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

- เตาเผา ELF11/6, Carbolite, UK
- ตู้อบความร้อน ED53, Binder, Germany
- อุปกรณ์สกรีน ชัยบูรณ์, ประเทศไทย
- เครื่องปั้มสุญญากาศ P.V.R., Italy
- เครื่องเป่าลมร้อน (Heat gun) GHG630DCE, Bosch, Germany
- เตาให้ความร้อน (Hot plate) OkWell, ประเทศไทย
- อ่างอัลตร้าโซนิก 1860QTD, VGT, China
- เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง AB204-S, Mettler Toledo, USA
- เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์ในการ Reflux
- ตู้ประกอบเซลล์
- อุปกรณ์ตัดกระจก
- ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter) หาวิทยาลัย
- เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน (Rotary Evaporator R-124), Büchi, Switzerland
- เครื่อง Ultrasonic processor

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

- ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis spectrophotometer), Biochrom Libra S22, UK.
- เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะกระแส-แรงดัน (IV characteristic), SMU, Keithley, USA.
- ไซคลิกโวลแทมเมตรี (Cyclic voltammetry), Potentiostat Galvanostat, Model Auto lab PGSTAT, Ger.
- เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (X-ray diffraction spectrometer), Bruker D8 Advance

- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด [Scanning Electron Microscope] Model JSM6480LV, JEOL
- เครื่อง Differential scanning calorimeter, DSC204 F1 Phoenix, NETZSCH, Ger.
- เครื่องวัดค่าความต้านทานของการถ่ายเทอิเล็กตรอน Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), Potentiostat Galvanostat, Model Auto lab PGSTAT, Ger.

3.5 วิธีดำเนินงานวิจัย

3.5.1 การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานวิจัย

การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานวิจัย โดยการสร้างมาตรฐานของงานวิจัยเริ่มจาก ประกอบเซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสง โดยส่วนประกอบหลักของเซลล์สุริยะชนิดย้อมไวแสง แสดงดังรูปที่ 3.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเซลล์ทดสอบ DSSC เครื่องมือและ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการหลักสำหรับการวิจัยมีดังนี้



รูปที่ 3.1 ส่วนประกอบของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง

 (ก) อุปกรณ์ตัดและเจาะกระจก – ทั้งอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเองได้แก่แท่นและมีดตัดกระจกที่สามารถใช้ ตัดกระจกในแนวเส้นตรงและอุปกรณ์ที่จัดซื้อได้แก่สว่านไฟฟ้าเจาะกระจกใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.5 – 1 มิลลิเมตร (ข) อุปกรณ์เตรียมขั้วไฟฟ้ารับแสง (photoanode) – ประกอบด้วยแท่นพิมพ์สกรีนและบล็อคสกรีน ผ้าใยสังเคราะห์ขนาด mesh 90T ใช้สำหรับพิมพ์ฟิล์มของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ที่มีความหนา ระดับไมโครเมตรลงบนกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า (FTO glass)

(ค) อุปกรณ์เตรียมขั้วไฟฟ้าร่วม (counter electrode) – ประกอบด้วยปืนลมร้อน (hot gun) ใช้งาน ในช่วงอุณหภูมิ 450– 550°C และท่อแก้วบังคับทิศทางลมร้อน

(ง) อุปกรณ์ประกอบเซลล์ทดสอบ – ใช้ประกอบเซลล์ทดสอบ DSSC โดยการอัดร้อน (hot press) ที่ อุณหภูมิ ~100°C

3.5.2 เซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสง

ประกอบและวิเคราะห์สมรรถนะของเซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสงระดับ ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งผลการวิเคราะห์สมรรถนะของเซลล์ ทดสอบมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสงที่ได้จะใช้เป็นค่ามาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบกับผลของเซลล์สุริยะ ชนิดสีย้อมไวแสงที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ โดยส่วนประกอบที่สำคัญมี ดังต่อไปนี้

3.5.2.1 การเตรียมขั้วไฟฟ้ารับแสง

ตัดกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า (fluorene-doped tin oxide: FTO) ขนาด 1.2 x 0.8 ตาราง เซนติเมตร แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดกระจก และผ่านการโซนิเคชันด้วยน้ำ ปราศจากอิออนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาที เพื่อกำจัดคราบฝุ่นต่าง ๆออกจากกระจก ล้างด้วย น้ำปราศจากอิออน แล้วตากให้แห้ง นำกระจกที่เตรียมไว้แช่ลงในสารละลายไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ 40 มิลลิโมลาร์ ที่เตรียมด้วยน้ำปราศจากอิออนที่เย็น แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 30 นาที หลังจากนั้นนำออกมาล้างด้วยน้ำปราศจากอิออนแล้วตากให้แห้ง

นำกระจกที่เตรียมไว้มาสกรีนชั้นไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดอนุภาคประมาณ 20 นาโนเมตร (titania paste 20 nm) พื้นที่ 0.5 x 0.5 ตารางเซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.1 โดยใช้บล็อกสกรีน (mesh 90T) จากนั้นวางทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 นาที แล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที วางทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาสกรีนซ้ำ 2 - 3 รอบ นำกระจกที่ผ่าน การสกรีนไปเผา โดยใช้อุณหภูมิและเวลาดังนี้ 325 องศาเซลเซียส 5 นาที, 375 องศาเซลเซียส 5 นาที, 450 องศาเซลเซียส 15 นาที และสุดท้าย 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น จนถึงอุณหภูมิห้อง นำกระจกที่ผ่านกระบวนการเผาแล้วไปแช่ในสารละลายไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ 40 มิลลิโมลาร์ นำไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนำออกมาล้าง ด้วยน้ำปราศจากอิออนแล้วตากให้แห้ง

เตรียมสีย้อมไวแสงชนิด Z907 Hydrophobic Dye ความเข้มข้น 0.3 มิลลิโมลาร์ ในตัวทำ ละลายผสมระหว่างอะซิโตไนไตรล์กับเติร์ตบิวทิลแอลกอฮอล์ อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร นำกระจก ที่เตรียมไว้ไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็น จนถึงอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แล้วนำไปแช่ในสารละลายสีย้อมไวแสงที่อุณหภูมิห้อง แช่ทิ้งไว้ ประมาณ 18 ชั่วโมงในสภาพมืด เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจึงนำออกมาล้างด้วยตัวทำละลายอะซิโตไน ไตรล์ เพื่อกำจัดสีย้อมไวแสงที่ไม่ถูกดูดซับ (adsorption) เมื่อเตรียมขั้วไฟฟ้ารับแสงแล้วเสร็จจะได้ ขั้วไฟฟ้ารับแสงแสดงดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการเตรียมขั้วไฟฟ้ารับแสง

Chulalongkorn University

3.5.2.2 การเตรียมขั้วไฟฟ้าร่วม

ตัดกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า ขนาด 1.2 x 0.8 ตารางเซนติเมตร เจาะรูขนาดเล็กบริเวณมุม ของกระจก แล้วนำไปทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดกระจก และโซนิเคชันที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 15 นาที เพื่อกำจัดคราบฝุ่นต่าง ๆ ออกจากกระจก ล้างด้วยน้ำปราศจากอิออน จากนั้นตาก ให้แห้ง หยดสารละลายแพลทินัมที่เตรียมจากกรดเฮกซะคลอโรแพลททินิก ความเข้มข้น 8 โมลาร์ ลง บนกระจกด้านนำไฟฟ้าและใช้ปืนลมร้อนให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แสดงดังรูปที่ 3.3 หลังจากนั้นวางทิ้งไว้ให้เย็น



รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการเตรียมเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด

3.5.2.3 การประกอบเซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสง



รูปที่ 3.4 เซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสงที่ประกอบสำเร็จ

เริ่มจากนำขั้วไฟฟ้ารับแสงที่แช่ในสารละลายสีย้อมไวแสงออกมาล้างด้วยตัวทำละลายอะซิโตไนไตรล์ 5 นาที เพื่อกำจัดสีย้อมไวแสงส่วนที่ไม่ได้ยึดเกาะกับไทเทเนียมไดออกไซด์ออก ตากจนขั้วไฟฟ้ารับ แสงแห้ง แล้วนำมาประกอบเข้ากับขั้วไฟฟ้าร่วมที่เตรียมไว้ด้วยแผ่นเทอร์โมพลาสติก (Surlyn) ความ หนาประมาณ 60 ไมครอน โดยการใช้เครื่องอัดร้อนที่ให้ความร้อนระยะสั้นอุณหภูมิ ~100 องศา เซลเซียส กับแผ่นเทอร์โมพลาสติกเพื่อเชื่อมขั้วทั้งสองขั้วให้ติดกัน จากนั้นเติมสารละลายอิเล็กโทร ไลต์เข้าไปในรูที่เจาะเตรียมไว้บนขั้วไฟฟ้าร่วมโดยใช้ระบบปั๊มสุญญากาศ ซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จะเข้าไปแทนที่อากาศที่ถูกดึงออกและปิดรูที่ใส่สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ได้เซลล์สุริยะมาตรฐานชนิด สีย้อมไวแสงที่ประกอบสำเร็จดังรูปที่ 3.4

3.5.2.4 การทดสอบเซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสง

ทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะมาตรฐานชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้เครื่องวัดค่ากระแสไฟฟ้าและ แรงดันไฟฟ้า (IV characteristic, SMU, Keithley, USA.)

วิเคราะห์ความต้านทานบริเวณหน้าสัมผัสของวัสดุในเซลล์สุริยะด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิง เคมีไฟฟ้า (EIS, Potentiostat Galvanostat, Model Auto lab PGSTAT, Ger.) ในสภาวะมืดที่ อุณหภูมิ 25 °C ความถี่ที่ใช้อยู่ในช่วง 1 mHz – 1 MHz กำหนดค่าความต่างศักย์ 0.1 – 0.7 โวลล์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Z-view

3.5.3 เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมระดับห้องปฏิบัติการ

ประกอบและวิเคราะห์สมรรถนะของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่ง จะศึกษาผลของการใช้ Nickel selenide เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมใน DSSC สารประกอบ Nickel selenide (Nio.85Se) มีความโปร่งแสงและนำไฟฟ้าได้ดี สามารถนามาผลิตเป็นขั้วไฟฟ้าร่วมสาหรับ DSSC ทดแทนการใช้โลหะแพลททินัมที่มีราคาแพง เพื่อลดต้นทุนในการผลิตเซลล์สุริยะขนาดใหญ่

3.5.3.1 การเตรียม Nickel selenide

เตรียมสารประกอบ Nickel selenide (Ni0.85Se) ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal) สารตั้งต้นที่ใช้คือ NiCl₂·6H₂O:Na₂Se₃·5H₂O อัตราส่วนโดยโมล 1:3 เริ่มจากละลาย NiCl₂·6H2O ใน น้ำกลั่น 40 มิลลิลิตร โดยใช้ภาชนะ Teflon-lined autoclave สำหรับใช้ในการทำไฮโดรเทอร์มอล ดังรูปที่ 3.5 เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อปรับค่า pH=14 กวนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาทีหลังจากนั้นเติมสาร Na₂Se₃·5H2O กวนผสม 5 นาที เติม N₂H₄·H₂O (50%) 10 มิลลิลิตร กวน ผสมเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นให้ความร้อนที่ 120 °C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง นำไปกรองจะได้สารที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีดำ



รูปที่ 3.5 ภาชนะ Teflon-lined autoclave

3.5.3.2 การเตรียมขั้วไฟฟ้าร่วม

ตัดกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า ขนาด 1.2 × 0.8 ตารางเซนติเมตร เจาะรูขนาดเล็กบริเวณมุม ของกระจก แล้วนำไปทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดกระจก และโซนิเคชันที่อุณหภูมิห้อง ้เป็นเวลา 15 นาที เพื่อกำจัดคราบฝุ่นต่าง ๆออกจากกระจก ล้างด้วยน้ำปราศจากอิออน จากนั้นตาก ให้แห้ง ติดเทปใสแบบบางลงบนกระจกด้านที่นำไฟฟ้า เพื่อเป็นกรอบสำหรับกำหนดพื้นที่สารนำ สารประกอบ Nickel selenide (Ni₀₈₅Se) ไปบดเปียกด้วยเอทานอล A.R. เกรด แล้วทำ การ disperse ด้วยเครื่อง Ultrasonic disperser ความถี่ 40 เฮิรตซ์ เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นหยดสาร (Drop cast) ลงบนกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้าที่เตรียมไว้และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.5.3.3 การประกอบ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วม

ประกอบ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมระดับห้องปฏิบัติการจะประกอบเซลล์คล้ายกับการประกอบ เซลล์สุริยะมาตรฐาน 3.5.2.3

3.5.3.4 การวิเคราะห์สารที่เตรียมได้และการทดสอบ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วม

ศึกษาโครงผลึกด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (X-ray diffraction spectrometer), Bruker D8 Advance โครงสร้างสัณฐานของอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด [Scan Scanning Electron Microscope], Model JSM6480LV, JEOL และ การรีดิวซ์และการ ออกซิไดซ์ของสาร Nickel selenide ที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี (Cyclic voltammetry), Potentiostat Galvanostat, Model Auto lab PGSTAT, Ger. ซึ่งจะเซตอุปกรณ์ ดังรูปที่ 3.6 ส่วนการเตรียมขั้วทำงาน (working electrode) เพื่อใช้ทดสอบเตรียมดังรูปที่ 3.7 ทดสอบประสิทธิภาพของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมโดยใช้เครื่องวัดค่ากระแสไฟฟ้าและ แรงดันไฟฟ้า (IV characteristic, SMU, Keithley, USA.) และวิเคราะห์ความต้านทานบริเวณ หน้าสัมผัสของวัสดุในเซลล์สุริยะด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิงเคมีไฟฟ้า (EIS, Potentiostat Galvanostat, Model Auto lab PGSTAT, Ger.) ในสภาวะมืดที่อุณหภูมิ 25 °C ความถี่ที่ใช้อยู่ ในช่วง 1 mHz – 1 MHz กำหนดค่าความต่างศักย์ 0.1 – 0.7 โวลล์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล ด้วยโปรแกรม Z-view



รูปที่ 3.6 วิธีการเซตอุปกรณ์และสารที่ใช้ในการทำไซคลิกโวลแทมเมตรี



รูปที่ 3.7 การเตรียมขั้วในฝั่ง working

3.5.4 เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์ระดับห้องปฏิบัติการ

ประกอบและวิเคราะห์สมรรถนะของ DSSC ที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์ระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะศึกษาผลของการใช้ GPE แทนอิเล็กโทรไลต์เหลว (Liquid Electrolyte) ใน DSSC เพื่อ แก้ปัญหาการรั่วซึมของอิเล็กโทรไลต์เหลวเมื่อประกอบเป็นเซลล์สุริยะขนาดใหญ่

3.5.4.1 การเตรียม GPE

เตรียม GPE ด้วยวิธีรีฟลักซ์ เริ่มจากผสม Poly(Ethylene oxide) 0.53 กรัม กับ Acetonitrile และ Propylene carbonate (20:1 v/v) กวนผสมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นเติมสารคู่รีดอกซ์ไอโอไดด์/ ไตรไอโอไดด์เตรียมจาก Nai 0.224 กรัม 12 0.04 กรัม และเติมสาร Acetamide ตาม % ที่กำหนดไว้ (0%, 5%, 8%, 10% โดยน้าหนักของ PEO) รีฟลักซ์เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จนสังเกตเห็นสารละลาย เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นกวนผสมทิ้งไว้ข้ามคืน แล้วระเหย Acetonitrile ด้วยเครื่องระเหยสารแบบ ลดความดันที่อุณหภูมิ 80 ℃ เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 ℃ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง

3.5.4.2 การประกอบ DSSC ที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์

ประกอบ DSSC ที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์ระดับห้องปฏิบัติการจะใช้เทปกาวสองหน้าแบบ บาง แทนการใช้แผ่นเทอร์โมพลาสติก การประกอบเซลล์ทดสอบจะต้องใช้ GPE ในปริมาณที่พอดีกับ ขนาดพื้นที่ บรรจุสารอิเล็กโทรไลต์

3.5.4.3 การวิเคราะห์สารที่เตรียมได้และการทดสอบ DSSC ที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์

ศึกษาค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของGPE ที่เตรียมได้ด้วยเครื่อง Differential scanning calorimeter, Model DSC204 F1 Phoenix, NETZSCH, Ger. และ ศึกษาค่าการเหนี่ยวนำไอออน (Ionic conductivity) ของ GPE ที่เตรียมได้โดยใช้ใช้มัลติมิเตอร์ แสดงดังรูป 3.8



รูปที่ 3.8 หน่วยวัดพื้นฐานของเครื่องมัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็นเครื่องมือปริมาณทางไฟฟ้าซึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยวัดหลาย ๆ หน่วยรวมอยู่ในเครื่องเดียวมี รายละเอียดต่อไปนี้

 หน่วยวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือความต่างศักย์ มีหน่วยวัดเป็น โวลท์ (V) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ใน เครื่องมัลติมิเตอร์ คือ V (Voltage)

- 2. หน่วยวัดความต้านทาน มีหน่วยวัดเป็น โอห์ม (Ω) สัญลักษณ์ที่ใช้ในเครื่องมัลติมิเตอร์ คือ Ω
- หน่วยวัดกระแสไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง มีหน่วยวัดเป็น มิลลิแอมแปร์ (mA) หรือแอมแปร์
 (A) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในเครื่องมัลติมิเตอร์ คือ Am

ใช้มัลติมิเตอร์ อ่านค่าความต้านทาน ในการปรับสวิตซ์มัลติมิเตอร์ให้อ่านค่าความต้านทานจากรูปที่ 3.7 จะมีย่านการวัดทั้งหมด 4 ย่านดังตารางที่ 3.1

ย่านการวัด	ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดที่ใช้วัดได้		
× 1	0.2Ω - 2kΩ		
× 10	2Ω - $20k\Omega$		
× 1K	200Ω - 2ΜΩ		
x 10K	200k Ω - 20 M Ω		

ตารางที่ 3.1 การตั้งย่านการวัดให้เหมาะสมต่อการวัดค่าความต้านทาน

การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าใน GPE เลือกใช้ย่านการวัด X10 คือ ค่าต่ำสุด 2 โอห์มถึงค่าสูงสุด 20 กิโลโอห์มแปลงค่าความต้านทานเป็นการเหนี่ยวนำไอออนได้จากสมการที่ (4.3) ทดสอบประสิทธิภาพ ของ DSSC ที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์โดยใช้เครื่องวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (IV characteristic, SMU, Keithley, USA.) และวิเคราะห์ความต้านทานบริเวณหน้าสัมผัสของวัสดุใน เซลล์สุริยะด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิงเคมีไฟฟ้า (EIS, Potentiostat Galvanostat, Model Auto lab PGSTAT, Ger.) ในสภาวะมืดที่อุณหภูมิ 25 °C ความถี่ที่ใช้อยู่ในช่วง 1 mHz – 1 MHz กำหนดค่าความต่างศักย์ 0.1 – 0.7 โวลล์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Z-view

3.5.5 เซลล์ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ระดับห้องปฏิบัติการ ประกอบและวิเคราะห์สมรรถนะของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะประกอบเซลล์คล้ายกับการประกอบ DSSC ที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็ก โทรไลต์และทดสอบประสิทธิภาพของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์โดย ใช้เครื่องวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (IV characteristic, SMU, Keithley, USA.) จากนั้น วิเคราะห์ความต้านทานบริเวณหน้าสัมผัสของวัสดุในเซลล์สุริยะด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิง เคมีไฟฟ้า (EIS, Potentiostat Galvanostat, Model Auto lab PGSTAT, Ger.) ในสภาวะมืดที่ อุณหภูมิ 25 °C ความถี่ที่ใช้อยู่ในช่วง 1 mHz – 1 MHz กำหนดค่าความต่างศักย์ 0.1 – 0.7 โวลล์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Z-view

3.5.6 ออกแบบและทดสอบมอดูลเซลล์ DSSC ที่มีพื้นที่รับแสงขนาดไม่เกิน 30 x 30 cm²



รูปที่ 3.9 ขั้นตอนการออกแบบโดยเพิ่มพื้นที่รับแสงของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง

จากขั้นตอนการออกแบบรูปที่ 3.9 ในการขยายขนาด DSSC โดยการเพิ่มพื้นที่รับแสงฝั่งแอโนดเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งจะขยายขนาดโดยการเพิ่มพื้นที่รับแสงเป็น 2.25 cm² (โดยใช้บล็อคสกรีนมีขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นจากระดับห้องปฏิบัติการ 9 เท่า แสดงดังรูปที่ 3.10)



รูปที่ 3.10 บล็อคสกรีนมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากระดับห้องปฏิบัติการ 9 เท่า

เริ่มด้วยส่วนของขั้วไฟฟ้ารับแสง ขั้นตอนแสดงดังรูปที่ 3.11 ซึ่งวิธีการเตรียมจะคล้ายกับส่วนของ ขั้วไฟฟ้ารับแสงของเซลล์สุริยะมาตรฐานก่อนหน้า (3.5.2.1)





รูปที่ 3.11 ลำดับการเตรียมขั้วไฟฟ้ารับแสงของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง ที่มีพื้นที่รับแสง 2.25 cm² ก) Pretreatment FTO ข) พิมพ์สกรีน TiO₂ ค) หลังจากผ่านการเผ่า ง) หลังจากแช่ Dye Z907

ส่วนขั้วไฟฟ้าร่วม ขั้นตอนวิธีการเตรียมคล้ายกับเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ปรับปรุงส่วนขั้วไฟฟ้า แต่ในการขยายขนาดเซลล์สุริยะนั้นจำเป็นต้องทาสีเพ้นท์เงิน ดังรูปที่ 3.12 เพื่อลดความต้านทาน กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขนาดของกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้าประกอบเซลล์สุริยะมาตรฐาน ชนิดสีย้อมไวแสงและ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีขนาดพื้นที่รับ แสง 2.25 cm²



รูปที่ 3.12 การทาสีเพ้นท์เงินบนเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง

ประกอบ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีพื้นที่รับแสง 2.25 cm² คล้าย กับการประกอบเซลล์สุริยะมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ ได้เป็นเซลล์ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วม และสารละลายอิเล็กโทรไลต์พื้นที่รับแสง 2.25 cm² ที่ประกอบสำเร็จ แสดงดังรูป 3.13 จากนั้น ทดสอบเซลล์ด้วยเครื่องวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (IV characteristic, SMU, Keithley, USA.)



บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

้งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาพัฒนาต้นแบบมอดูลเซลล์สุริยะเคมีไฟฟ้าเชิงแสง โดยศึกษาปัจจัยที่มีผล ต่อการผลิตเซลล์สุริยะขนาดใหญ่ หนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตคือต้นทุนที่ใช้ในการผลิตโดยเลือกใช้ สารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมใน DSSC เริ่มด้วยการวิเคราะห์ผลของสารประกอบ ้นิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมขึ้นเอง ใช้เทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันยืนยันองค์ประกอบและโครงสร้างผลึก ้ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของอนุภาคสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ้อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ศึกษาความโปร่งแสงของสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้เทียบกับ แพลทนินัมด้วย ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และศึกษาการรีดิวซ์และการออกซิไดซ์ของขั้ว นิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้เทียบกับขั้วแพลททินัมด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี ปัจจัยที่สองคือ ้เสถียรภาพของเซลล์สุริยะโดยเลือกใช้ GPE แทนการใช้อิเล็กโทรไลต์เหลว เริ่มด้วยการวิเคราะห์หมู่ ฟังก์ชันของ GPE ที่ไม่มีการผสมและมีการผสมสารอะเซตาไมด์ ศึกษาอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะ คล้ายแก้ว ศึกษาการเหนี่ยวนำไอออน จากนั้นทดสอบสมรรถนะของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วม และอิเล็กโทรไลต์เทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ความต้านทาน บริเวณหน้าสัมผัสของวัสดุในเซลล์สุริยะระดับห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิง เคมีไฟฟ้าในสภาวะมืด เส้นทางการผลิตต้นแบบมอดูล DSSC ที่มีพื้นที่รับแสงขนาดใหญ่นั้น เริ่มจาก ้ศึกษาประสิทธิภาพของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์เทียบกับเซลล์ สุริยะมาตรฐาน โดยมีพื้นที่รับแสงเป็น 2.25 cm² (เพิ่มขึ้นจากระดับห้องปฏิบัติการ 9 เท่า)

4.1 ผลวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันเพื่อยืนยันองค์ประกอบและโครงสร้างผลึกของ สารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้

พบว่าสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้มีโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล ปรากฏยอดกราฟ แสดงอัตลักษณ์ของ Ni_{0.85}Se บริเวณที่เป็นจุดสามเหลี่ยมสีแดง แสดงดังรูปที่ 4.1 ตำแหน่ง 2**θ** = 33.2, 44.8, 50.5, 60.3, 61.7 และ 70.7 องศา และยืนยันโครงสร้างเฮกซะโกนอลของสารประกอบ นิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้ ดังนั้นการสังเคราะห์สารด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลสามารถใช้ได้ นอกจากนี้ นิกเกิลเซเลไนด์สัดส่วนอื่นก็สามารถนำมาใช้ในงาน DSSC ได้เหมือนกันแต่สมบัติเชิงแสงและสมบัติ การนำไฟฟ้าด้อยกว่า Ni:Se = 0.85:1



4.2 ผลวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อดูสัณฐานวิทยาของอนุภาค สารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้



รูปที่ 4.2 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ ความละเอียด 20,000 เท่า (ซ้าย) และ 10,000 เท่า (ขวา)

จากรูปที่ 4.2 พบว่า อนุภาคของสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้มีขนาดค่อนข้างเล็ก มีขนาด อนุภาคเฉลี่ยประมาณ 0.4 ไมโครเมตร อนุภาคเกาะกันเป็นกลุ่มมีลักษณะโครงสร้างที่เป็นรูพรุน ส่งผลให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสกับสารอิเล็กโทรไลต์เพิ่มมากขึ้น เมื่อนำสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ใช้เป็น ขั้วไฟฟ้าร่วมใน DSSC จะช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของไตรไอโอไดด์ไอออนได้ดี ซึ่งจะ ยืนยันอัตราการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของไตรไอโอไดด์ไอออนของสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ในการ ทดลอง (4.3)

4.3 ผลวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี เพื่อดูการรีดิวซ์และการออกซิไดซ์ของขั้วนิกเกิล เซเลไนด์ที่เตรียมได้เทียบกับขั้วแพลททินัม ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี



รูปที่ 4.3 ไซคลิกโวลแทมมาแกรมของขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้เปรียบเทียบกับขั้วแพลททินัม

การทดลองใช้ระบบ 3 ขั้ว ได้แก่ขั้วทำงาน (working electrode) เปรียบเทียบระหว่าง แพลททินัมและนิกเกิลเซเลไนด์ ขั้วไฟฟ้าร่วมใช้แท่งแพลททินัมบริสุทธิ์ และขั้วไฟฟ้าอ้างอิงเมอคิวรี คลอไรด์ อัตราการสแกน 20 มิลลิโวลท์ต่อวินาที สารละลายคู่รีดอกซ์ไอโอไดด์ไอออน (I⁻) กับไตรไอโอ ไดด์ไอออน (I₃⁻) ส่วนรายละเอียดวิธีเตรียมการทดลองดังแสดงในหัวข้อ 3.5.3.4 ซึ่งผลการทดลอง แสดงในรูปที่ 4.3 กราฟไซคลิกโวลแทมมาแกรมปรากฏยอดกราฟสองคู่สอดคล้องกับปฏิกิริยารีดอกซ์ 2 ปฏิกิริยาดังนี้ [24]

ผลทดสอบขั้วทำงานแพลททินัมปรากฏยอดกราฟสองคู่ ยอดกราฟแคโทดิกแรกพบที่แรงดันไฟฟ้า 0.29 V เกิดจากปฏิกิริยาผันกลับในสมการ (4.1) ยอดกราฟแคโทดิกที่สองพบที่แรงดันไฟฟ้า 0.79 V สอดคล้องกับปฏิกิริยาในสมการผันกลับที่ (4.2) ขณะที่ผลทดสอบขั้วทำงานนิกเกิลเซเลไนด์ปรากฏ ยอดกราฟสองคู่เช่นกัน ยอดกราฟแคโทดิกแรกและยอดกราฟแคโทดิกที่สอง พบที่แรงดันไฟฟ้า 0.20 V และ 0.71 V สอดคล้องกับปฏิกิริยาในสมการ (4.1) และ (4.2) ตามลำดับ การที่ผลไซคลิกโวลแทม มาแกรมของขั้วทำงานทั้งสองชนิดมีลักษณะคล้ายกันและตำแหน่งยอดกราฟปรากฏที่แรงดันไฟฟ้าใน ย่านเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้นั้นสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใน DSSC ได้

ปฏิกิริยาในสมการที่ (4.1) เกี่ยวข้องกับการทำงานของขั้วไฟฟ้าร่วม เนื่องจากขั้วไฟฟ้าร่วมทำหน้าที่ เร่งปฏิกิริยารีดักชันของ triiodide species พารามิเตอร์ที่สอดคล้องกับรูปไซคลิกโวลแทมมาแกรม สรุปไว้ในตารางที่ 4.1

Counter electrode	J _{red} (mAcm ⁻²)	E _{pp} (mV)	J _{ox1} /J _{red}
Pt	0.49	312	1.51
Ni _{0.85} Se	0.22	390	1.63

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทางเคมีไฟฟ้าจากไซคลิกโวลแทมมาแกรมจากรูปที่ 4.3

พารามิเตอร์ที่มีผลต่อปฏิกิริยารีดักชั้นของ triiodide species ได้แก่

 ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงสุดของปฏิกิริยารีดักชัน (|J_{red}) ถ้า |J_{red}| มีค่ามากแสดงว่า ปฏิกิริยารีดักชันเกิดได้เร็ว [22]

- ผลต่างระหว่างศักย์ไฟฟ้าของยอดกราฟแอโนดิกแรก (Anodic peak I) กับยอดกราฟแคโทดิกแรก (Cathodic peak I) (the peak to peak potential separation = E_{pp}) สามารถคำนวณได้จาก สูตร |E_a – E_c| โดยค่า E_a และ E_c แทนค่าศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งยอดกราฟแอโนดิกและแคโทดิก ตามลำดับ ปฏิกิริยารีดอกซ์ที่มีค่า E_{pp} ต่ำแสดงถึงกัมมันตภาพเชิงเร่งปฏิกิริยา (Catalytic activity) ที่สูง [25]
- อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงสุดของปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อค่าสัมบูรณ์ของ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงสุดของปฏิกิริยารีดักชัน (J_{ox}/|J_{red}) เป็นพารามิเตอร์ประเมิน ความสามารถเชิงเร่งปฏิกิริยา (catalytic activity) ค่า J_{ox}/|J_{red}| เข้าใกล้ 1 แสดงถึงอัตราการ เกิดปฏิกิริยารีดักชันเร็วเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นผลเนื่องมาจาก catalytic activity ของตัวเร่งปฏิกิริยา

จากตารางที่ 4.1 ขั้วทำงานแพลททินัมมีค่า |J_{red}| = 0.49 mA/cm² มากกว่าขั้วทำงานนิกเกิลเซเลไนด์ ที่เตรียมได้ (0.22 mA/cm²) แสดงว่าขั้วแพลททินัมเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ ขณะที่ ขั้วแพลททินัมให้ค่า E_{pp} น้อยกว่าขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้ (312 และ 390 mV ตามลำดับ) แสดง ให้เห็นว่าขั้วแพลททินัมมีกัมมันตภาพเชิงเร่งปฏิกิริยาสูงกว่าขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ ค่าอัตราส่วน J_{ox}/|J_{red}| ของขั้วแพลททินัมเข้าใกล้ 1 มากกว่าขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ ซึ่งแสดงถึงความว่องไวขั้วแพลททินัมมีความ เสถียรในเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์มากกว่าขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้

> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University




รูปที่ 4.4 ค่าความโปร่งแสงของขั้วไฟฟ้าร่วมที่เคลือบด้วยโลหะแพลททินัมและสารนิกเกิลเซเลไนด์

จากรูปที่ 4.4 เมื่อแสงตกกระทบมีความยาวคลื่นตั้งแต่ 350 nm ขึ้นไปจะเห็นได้ว่าสารนิกเกิลเซเล ในด์มีค่าความโปร่งแสง มากกว่า 65% อีกทั้งยังมีค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าความโปร่งแสงของ กระจกนำไฟฟ้าเคลือบด้วยโลหะแพลททินัม (> 80%) ในช่วงความยาวคลื่นเดียวกัน และถ้าสังเกต ด้วยตาเปล่าจะเห็นลักษณะของขั้วไฟฟ้าร่วมที่เคลือบด้วยโลหะแพลททินัมและสารนิกเกิลเซเลไนด์ แสดงดังรูปที่ 4.5 แต่เมื่อนำขั้วไฟฟ้าที่เคลือบด้วยโลหะแพลททินัมและสารนิกเกิลเซเลไนด์ประกอบ เป็นเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงโดยหยดสารละลายอิเล็กโทรไลต์เหลวเข้าไปเซลล์ พบว่าขั้วไฟฟ้าที่ เคลือบด้วยสารนิกเกิลเซเลไนด์นั้นมีความโปร่งแสงทีดีขึ้น แสดงดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.5 ลักษณะของขั้วไฟฟ้าร่วมที่เคลือบด้วยโลหะแพลททินัม (ซ้าย) และสารนิกเกิลเซเลไนด์ (ขวา)



รูปที่ 4.6 เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมเป็นโลหะแพลททินัม (ซ้าย) และสารนิกเกิลเซเลไนด์ (ขวา)

เนื่องจากขั้วไฟฟ้าที่เคลือบด้วยสารนิกเกิลเซเลไนด์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้จริง ยกตัวอย่างเช่น นำไปประยุกต์ใช้เป็นกระจกหน้าต่างของอาคารบ้านเรือน ดังนั้นเซลล์สุริยะ จำเป็นต้องมีความโปร่งแสงไม่น้อยกว่า 60%

4.5 ผลศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมเทียบกับเซลล์ สุริยะมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ



รูปที่ 4.7 ส่วนประกอบของ NiSe-DSSC

เซลล์ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมโดยใช้สารนิกเกิลเซเลไนด์และเซลล์ DSSC มาตรฐาน มี ส่วนประกอบภายในเซลล์ทดสอบ แสดงดังรูปที่ 4.7 และจากรูปที่ 4.8 จะเห็นได้ว่า DSSC ที่ปรับปรุง ขั้วไฟฟ้าร่วมโดยใช้สารนิกเกิลเซเลไนด์ ให้ค่าความหนาแน่นกระแสลัดวงจร (Jsc) ลดลง เมื่อเทียบ กับเซลล์สุริยะมาตรฐานที่ใช้สารแพลททินัมเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม เนื่องจากขั้วแพลททินัมนั้นมีความเร็วใน เกิดปฏิกิริยาที่เร็วกว่าขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้ ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลการวิเคราะห์ด้วย เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี ตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.2 ประสิทธิภาพและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมเทียบกับเซลล์ สุริยะมาตรฐาน พื้นที่รับแสง 0.25 cm² วัดภายใต้แสงอาทิตย์จำลอง ความเข้มแสง AM 1.5 G (~100 mW/cm²)

CEs	V _{oc} (V)	J _{sc} (mA/cm²)	FF	%PCE
Liq/Pt	0.68	6.9	0.65	3.0%
Ni _{0.85} Se	0.67	5.8	0.66	2.6%



รูปที่ 4.8 กราฟ J-V ของเซลล์ NiSe-DSSC (พื้นที่รับแสง 0.25 cm²)

โดยที่ J_{sc} ความหนาแน่นกระแสลัดวงจร (mA/cm²)

- V_{oc} ศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด (V)
- FF ค่าฟิลล์แฟกเตอร์

%PCE ประสิทธิภาพรวม (%)

จากข้อมูลในตารางที่ 4.2 พบว่า DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมให้ค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด และค่าฟิลล์ แฟกเตอร์ ที่ใกล้เคียงกับเซลล์สุริยะมาตรฐาน ส่วนค่าความหนาแน่นกระแสลัดวงจร (Jsc) ของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วม (5.8 mA/cm²) มีค่าน้อยกว่าเซลล์สุริยะมาตรฐาน (6.9 mA/cm²) ซึ่ง จะส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมลดลงจากเซลล์ สุริยะมาตรฐานเล็กน้อย ดังนั้นขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้มีความเหมาะสมพอที่จะนำมาใช้แทนขั้ว แพลททินัมใน DSSC เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต





รูปที่ 4.9 DSC thermograms ของ GPE ที่เตรียมได้

จากรูปที่ 4.9 แสดงอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Tg) คืออุณหภูมิที่สารเกิดการเปลี่ยนแปลง จากสภาวะแข็งเปราะคล้ายผลึกกลายเป็นสภาวะยืดหยุ่นคล้ายยาง สามารถหาได้จากจุดกึ่งกลาง (Midpoint) ของ DSC thermogram กรณีพอลิเมอร์ Tg มีค่าสูงขึ้น แสดงว่าพอลิเมอร์นั้นมีโครงสร้าง ที่เป็นระเบียบ (Crystalline) อยู่ในเนื้อวัสดุมากขึ้น แสดงดังรูปที่ 4.10 ดังนั้นต้องใช้อุณหภูมิสูงขึ้นจึง ทำให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแข็งเปราะกลายเป็นสภาวะยืดหยุ่น ดังนั้นเจลพอลิเมอร์ที่มี Tg ต่ำลงแสดงว่าเจลพอลิเมอร์นั้นเริ่มมีเฟสอสัณฐาน (amorphous) หรือโครงสร้างแบบไม่เป็น ระเบียบ (non-crystalline) มากขึ้น จากผลการทดลองค่า Tg ของ GPE ที่ไม่มีการผสมและมีการ ผสมสารอะเซตาไมด์ตามอัตราที่กำหนดเป็น 0%, 5%, 8% และ 10% โดยน้ำหนัก แสดงตารางที่ 4.3



รูปที่ 4.10 แบบจำลอง Fringed-micelle แสดงโครงสร้างผลึกพอลิเมอร์ [26]

ตารางที่ 4.3 ค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วและค่าการเหนี่ยวนำไอออนของ GPE ที่ไม่มีการ ผสมและมีการผสมสารอะเซตาไมด์ตามอัตราที่กำหนด

GPEs with	Tg (°C)	R (k Ω)	σ x 10 ⁻⁴ (S/cm)
0% actm	-93.5	16.3	8.7
5% actm	-96.6	8.4	17.0
8% actm	-98.6	7.2	19.8
10% actm	-99.2	13.0	10.9

GHULALONGKORN UNIVERSITY จากตารางที่ 4.3 พบว่าปริมาณสารอะเซตาไมด์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ GPE มีค่า Tg ลดลง แสดงให้เห็นว่าใน โครงสร้างของ GPE มีส่วนที่เป็นลักษณะเฟสอสัณฐานเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดความเกะกะของสายโซ่พอ ้ลิเมอร์ทำให้มีช่องว่างอิสระดังนั้นไอออนเกิดการถ่ายเทได้ดี ซึ่งจะส่งผลดีทางอ้อมคือจะช่วยเพิ่มการ เหนี่ยวนำไอออนของไอโอไดด์และไตรไอโอไดด์สามารถยืนยันด้วยผลการทดลองต่อไป

ผลความต้านทานไฟฟ้า พบว่าปริมาณสารอะเซตาไมด์ที่เพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานไฟฟ้าของ GPE จะ ิลดลง เนื่องจาก GPE มีเฟส amorphous มากขึ้น โมเลกุลของสารห่างกันส่งผลให้ไอออนของไอโอ ไดด์และไตรไอโอไดด์ในเนื้อของพอลิเมอร์เมทริกซ์สามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น เมื่อ GPE มีความเป็น amorphous มากขึ้นทำให้ค่าความต้านทานเชิงไฟฟ้าของ GPE ลดลง และสิ่งที่สัมพันธ์กับค่าความ ้ต้านทานเชิงไฟฟ้าก็คือค่าการเหนี่ยวนำไอออนของ GPF

กรณี DSSC มี GPE เป็นส่วนประกอบภายในเซลล์ค่าประสิทธิภาพรวมของเซลล์สุริยะส่วนใหญ่จะ ขึ้นอยู่กับความคล่องตัว (mobility) ของสารคู่รีดอกซ์และค่าการเหนี่ยวนำไอออนของ GPE ดังนั้นค่า การนำไอออนของ GPE, **σ** (S/cm) ที่เตรียมได้สามารถคำนวณได้จากความต้านทานของ GPE โดยใช้ สูตรสมการ (4.3)

$$\sigma = rac{l}{R_b A}$$
สมการ (4.3)

โดย σ ค่าการนำไอออนสารอิเล็กโทรไลต์ หน่วยเป็น S/cm

- ี ไ ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า หน่วยเป็น cm
- R_b ความต้านทาน bulk, ความทานต้านของเจลพอลิเมอร์ หน่วยเป็นโอห์ม
- A พื้นที่หน้าตัดของสารอิเล็กโทรไลต์ หน่วยเป็น cm²

จากตารางที่ 4.3 ค่าการนำไอออนของ GPE แปรผกผันกับค่าความต้านทานไฟฟ้า ปริมาณสารอะเซ ตาไมด์ที่เพิ่มขึ้น (จาก 0% ไปถึง 8% โดยน้ำหนัก) ทำให้ค่าการนำไอออนของ GPE เพิ่มขึ้น (จาก 8.7 × 10⁻⁴ เป็น 19.8 × 10⁻⁴ S/cm) แต่เมื่อเพิ่มปริมาณสารอะเซตาไมด์ถึง 10% โดยน้ำหนัก ค่าความ ต้านทานไฟฟ้าของ GPE กลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นผลเนื่องมาจากอะเซตาไมด์ปริมาณมากเกินไปจะ เหนี่ยวนำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างอะเซตาไมด์กับไตรไอโอไดด์ไอออนใน GPE [20] ทำให้ ค่าการเหนี่ยวนำไอออนลดลง ดังนั้น GPE ผสมสารอะเซตาไมด์ 8% โดยน้ำหนัก มีความเหมาะสม มากที่สุดสำหรับใช้เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ใน DSSC ต่อไป

จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.7 ผลศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ



รูปที่ 4.11 ส่วนประกอบของ GPE-DSCC



รูปที่ 4.12 กราฟ J-V ของ GPE-DSSC (พื้นที่รับแสง 0.25 cm²)

ตารางที่ 4.4 ประสิทธิภาพและพารามิเตอร์ต่างๆของ DSSC ที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์เทียบ กับเซลล์สุริยะมาตรฐาน พื้นที่รับแสง 0.25 cm² วัดภายใต้แสงอาทิตย์จำลอง ความเข้มแสง AM 1.5 G (~100 mW/cm²)

Electrolytes	lectrolytes V _{oc} (V)		FF	%PCE
Liquid	0.68	เหาวิทยาลัย	0.65	3.0%
GPE 0% actm	0.70 GKO	RN U ^{3.6} /ERSI	0.66	1.7%
GPE 5% actm	0.70	4.2	0.69	2.0%
GPE 8% actm	0.71	5.6	0.64	2.6%
GPE 10% actm	0.71	5.2	0.65	2.0%

เซลล์ DSSC ที่ปรับปรุงสารละลายอิเล็กโทรไลต์โดยใช้ GPE มีส่วนประกอบภายในเซลล์ทดสอบ แสดง ดังรูปที่ 4.11 ซึ่งกราฟ J-V ของเซลล์ทดสอบที่วัดได้จากเครื่อง IV-test แสดงดังรูปที่ 4.12 และ จาก ตารางที่ 4.4 พบว่าปริมาณสารอะเซตาไมด์ใน GPE ที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าความหนาแน่นกระแสลัดวงจร (Jsc) เพิ่มขึ้น เนื่องจากในการผสมสารอะเซตาไมด์เพิ่มขึ้นนั้นทำให้ไอออนใน GPE เกิดการถ่ายเทได้ดี ขึ้นและส่งผลให้ค่าการเหนี่ยวนำไอออนของ GPE เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณอะเซตาไมด์ 10 % โดยน้ำหนัก กลับทำให้ Jsc ลดลงเพราะสารอะเซตาไมด์ที่ใส่เพิ่มมากเกินไปจะเหนี่ยวนำให้เกิดสารประกอบ เชิงซ้อนระหว่างอะเซตาไมด์กับไตรไอโอไดด์ไอออน ซึ่งแนวโน้มของ GPE เป็นไปในทิศทางเดียวกับค่า การเหนี่ยวนำไอออน ค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิดและค่าฟิลล์แฟกเตอร์ให้ผลประสิทธิภาพใกล้เคียงกันใน ทุกอัตราส่วน โดย GPE-DSSC ผสมสารอะเซตาไมด์ 8 % โดยน้ำหนัก ให้ค่า PCE สูงที่สุด (2.6 %) ใกล้เคียงกับผลของ DSSC ที่ผลิตจากอิเล็กโทรไลต์เหลว ดังนั้น GPE ที่ผสมสารอะเซตาไมด์ 8 % โดย น้ำหนัก มีความเหมาะสมพอที่จะนำมาใช้แทนสารละลายอิเล็กโทรไลต์เหลวใน DSSC เพื่อช่วยลดการ รั่วซึมของสารอิเล็กโทรไลต์

4.8 ผลศึกษาประสิทธิภาพของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์เทียบ



รูปที่ 4.13 ส่วนประกอบของ NiSe/GPE-DSSC



รูปที่ 4.14 กราฟ J-V ของ NiSe/GPE-DSSC (พื้นที่รับแสง 0.25 cm²)

DSSCs 0.25 cm ²	V _{oc} (V)	J _{sc} (mA/cm ²)	FF	%PCE
Liq EL + Pt [STD]	0.68	6.9	0.65	3.0%
Range of Cells	0.65-0.68	6.3-7.1	0.64-0.66	2.8-3.0%
Liq EL + Ni _{0.85} Se [N]	0.67	5.8	0.66	2.6%
Range of Cells	0.63-0.67	5.5-6.0	0.60-0.66	2.2-2.6%
GPE 8% + Pt [W]	0.71	5.6	0.64	2.6%
Range of Cells	0.7-0.71	4.3-5.6	0.64-0.69	2.1-2.6%
GPE 8% + Ni _{0.85} Se [H]	0.72	6.5	0.46	2.2%
Range of Cells	0.70-0.72	6.3-6.5	0.45-0.47	2.0-2.2%

ตารางที่ 4.5 ประสิทธิภาพและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิ เล็กโทรไลต์เทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐาน พื้นที่รับแสง 0.25 cm²

เซลล์ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ มีส่วนประกอบภายในเซลล์ทดสอบ แสดงดังรูปที่ 4.13 ซึ่งกราฟ J-V ของเซลล์ทดสอบที่วัดได้จากเครื่อง IV-test แสดงดังรูปที่ 4.14 และ จากตารางที่ 4.5 พบว่าเมื่อ DSSC ที่ใช้ GPE ผสมสารอะเซตาไมด์ 8 % โดยน้ำหนัก ร่วมกับขั้วไฟฟ้า ร่วมที่เป็นสารนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้จะเห็นได้ว่าค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด (V_{oc} = 0.72 V) มีค่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเซลล์สุริยะมาตรฐาน (V_{oc} = 0.68 V) ค่าความหนาแน่นวงจรปิด (J_{sc} = 6.5 mA/cm²) ยังให้ค่าความหนาแน่นวงจรปิดน้อยกว่าเซลล์สุริยะมาตรฐาน (J_{sc} = 6.9 mA/cm²) ซึ่ง ยืนยันด้วยผลการวิเคราะห์ความต้านทานบริเวณหน้าสัมผัสของวัสดุในเซลล์สุริยะ (impedance analysis) หัวข้อถัดไป แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ DSSC ที่ปรับปรุงองค์ประกอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง พบว่า NiSe/GPE-DSSC ผสมสารอะเซตาไมด์ 8 % โดยน้ำหนัก ให้ค่า V_{oc} สูงกว่า ส่วนค่า FF นั้นต่ำ กว่าเซลล์สุริยะมาตรฐานเล็กน้อย ส่งผลให้เซลล์ NiSe/GPE-DSSC มีค่า PCE = 2.2% ลดลงเมื่อเทียบ เซลล์สุริยะมาตรฐาน (PCE = 3.0%) 4.9 ผลวิเคราะห์ความต้านทานบริเวณหน้าสัมผัสของวัสดุในเซลล์สุริยะระดับห้องปฏิบัติการด้วย เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิงเคมีไฟฟ้าในสภาวะมืด



66



รูปที่ 4.15 ก) รูปแบบวงจรสำหรับการฟิตติ้งผลการทดลอง EIS, ข) R_{cT} ที่ bias voltage แตกต่างกัน ของ DSSC มาตรฐาน และDSSC ที่ปรับปรุงส่วนประกอบ, ค) Z_w ที่ bias voltage แตกต่างกันของ DSSC มาตรฐาน และDSSC ที่ปรับปรุงส่วนประกอบ, ง) R_{cE} ที่ bias voltage แตกต่างกันของ DSSC มาตรฐาน และDSSC ที่ปรับปรุงส่วนประกอบ

จากผลการทดลองรูปที่ 4.15 (ก) แสดงรูปแบบวงจรสมมูลทางไฟฟ้าของการวัดค่าความขัดรวม (impedance) ค่า Rs คือค่าความต้านทานอนุกรมของกระจกที่เคลือบด้วยสารนำไฟฟ้า (FTO) ช่วง ความถี่ประมาณ 1 MHz, ค่า R_{CT} (Charge transfer resistance) คือค่าความต้านทานของการถ่าย โอนอิเล็กตรอนที่บริเวณหน้าสัมผัสระหว่างสารกึ่งตัวนำไทเทเนียมไดออกไซด์กับสารละลายอิเล็กโทร ไลต์ (TiO₂/EL) ช่วงความถี่ประมาณ 1-100 Hz ซึ่งบริเวณหน้าสัมผัสนี้เกิดขึ้นที่บริเวณขั้ว Anode และจำเป็นต้องมีค่า R_{CT} มาก เพราะจะช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยา recombination via electrolyte แสดงดังรูปที่ 4.16, ค่า R_{CE} (Counter electrode resistance) คือค่าความต้านทาน ของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่บริเวณหน้าสัมผัสระหว่างสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับขั้วไฟฟ้าร่วม (EL/CE) ช่วงความถี่สูงประมาณ 1-100 kHz ซึ่งบริเวณหน้าสัมผัสนี้เกิดขึ้นบริเวณขั้ว Cathode และ จำเป็นต้องมีค่า R_{CE} น้อยๆ เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนได้ดี และค่า W1 หรือ Z_w คือค่าความ ต้านทานวาร์บูร์ก (Warburg resistance) ซึ่งอยู่ในช่วงความถี่ต่ำประมาณ 100 mHz ซึ่งในการ ทดลองนี้ศึกษาค่าพารามิเตอร์เฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในเซลล์สุริยะ นั้นคือ ค่า R_{CT}, ค่า R_{CE} และ ค่า Z_w ซึ่งค่าพารามิเตอร์ R1 ของ DSSC มาตรฐาน และDSSC ที่ปรับปรุง ส่วนประกอบอยู่ที่ประมาณ 15 Ohm



รูปที่ 4.16 ปฏิกิริยา recombination via electrolyte

 แลของการใช้ GPE ผสมสารอะเซตาไมด์ 8 % โดยน้ำหนักแทนสารละลายอิเล็กโทรไลต์เหลว จำเป็นต้องศึกษาค่าความต้านทานบริเวณหน้าสัมผัสระหว่าง TiO₂/EL และค่าความต้านทาน Z_w จากรูปที่ 4.15 (ข) พบว่าความต้านทาน R_{CT} ของเซลล์ทดสอบ Liq/Pt-DSSC มีค่าสูงที่สุดตลอดช่วง แรงดันไบแอส (bias voltage) 0.2 - 0.7 V ส่งผลให้การตกกลับของอิเล็กตรอน (electron recombination) จากชั้น TiO₂ ไปยังอิเล็กโทรไลต์เหลวของเซลล์ทดสอบ Liq/Pt-DSSC มีอัตราต่ำ ที่สุด แต่ในเซลล์ทดสอบ GPE/Pt-DSSC กลับพบว่าความต้านทาน R_{CT} ในช่วงแรงดันไบแอสสูง 0.5 - 0.8 V มีค่าต่ำกว่าเซลล์ทดสอบอื่น ๆ อาจเป็นผลเนื่องมาจากในสภาวะความหนาแน่นอิเล็กตรอนสูง (high electron density) อิเล็กตรอนในชั้น TiO₂ มีปฏิสัมพันธ์กับ reducing species ในอิเล็กโทร ไลต์ GPE ได้มากกว่าในอิเล็กโทรไลต์เหลว อย่างไรก็ตามในเซลล์ทดสอบที่ใช้ขั้วไฟฟ้าร่วม NiSe กลับ พบว่าความต้านทาน R_{CT} มีค่าอยู่ระหว่าง 100 - 300 โอห์มตลอดทั้งช่วงแรงดันไบแอสโดยไม่ขึ้นกับ ชนิดของอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ สรุปเบื้องต้นได้ว่าขั้วไฟฟ้าร่วม NiSe มีส่วนช่วยให้อัตราการถ่ายโอน อิเล็กตรอนในชั้น TiO₂, อัตราการตกกลับของอิเล็กตรอนบริเวณหน้าสัมผัส TiO₂/EL และอัตราการ ถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากขั้วไฟฟ้าร่วมสู่อิเล็กโทรไลต์ อยู่ในสภาวะสมดุล (equilibrium) โดยไม่ขึ้นกับ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนหรือชนิดของอิเล็กโทรไลต์ จากรูปที่ 4.15 (ค) แสดงผลเปรียบเทียบ Z_w ของเซลล์ทดสอบทั้งสี่เซลล์ในช่วงแรงดันไบแอส 0.5 – 0.7 V พบว่าค่า Z_w มีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มแรงดันไบแอส โดยเซลล์ทดสอบที่ใช้อิเล็กโทรไลต์เหลว เหมือนกัน (Liq/Pt-DSSC และ Liq/NiSe-DSSC) จะมีค่า Z_w ระดับใกล้เคียงกันตลอดช่วงแรงดัน ไบแอสที่ทดสอบ ในขณะที่เซลล์ทดสอบที่ใช้ GPE (GPE/Pt–DSSC) กลับมีความต้านทานการแพร่ของ ประจุต่ำกว่าเซลล์ทดสอบ Liq/Pt-DSSC และ Liq/NiSe-DSSC แสดงให้เห็นว่าเมทริกซ์ของพอลิเมอร์ ใน GPE มีส่วนช่วยให้อิเล็กโตรอนถ่ายโอนได้เร็วกว่าการแพร่ของ redox species ในอิเล็กโทรไลต์ เหลว สำหรับเซลล์ทดสอบ GPE/NiSe-DSSC นั้นพบว่า Z_w มีค่าสูงกว่าเซลล์ GPE/Pt–DSSC แต่ต่ำ กว่าเซลล์ทดสอบที่ใช้อิเล็กโทรไลต์ เหลว ทั้งสองเซลล์ (Liq/Pt-DSSC และ Liq/NiSe-DSSC) สันนิษฐานว่าปฏิกิริยา reduction ที่ขั้วไฟฟ้าร่วมในเซลล์ GPE/NiSe-DSSC เกิดช้ากว่าเซลล์ GPE/Pt–DSSC ที่ใช้โลหะแพลททินัมผลิตเป็นขั้วไฟฟ้าร่วม

 2. ผลของการใช้สารนิกเกิลเซเลไนด์แทนโลหะแพลททินัม จำเป็นต้องศึกษาค่าความต้านทานของการ ถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่บริเวณหน้าสัมผัสระหว่างสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับขั้วไฟฟ้าร่วม (EL/CE) รูปที่
 4.15 (ง) แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรงดันไบแอสต่ำถึงปานกลาง 0.2 – 0.5 V ความต้านทาน R_{CE} ของ เซลล์ทดสอบ GPE/NiSe-DSSC มีค่าต่ำกว่าเซลล์ทดสอบอื่น ๆ ส่งผลให้อิเล็กตรอนถ่ายเทจาก ขั้วไฟฟ้าร่วมสู่อิเล็กโทรไลต์ได้เร็วกว่า อย่างไรก็ตามในช่วงแรงดันไบแอสสูง 0.5 – 0.7 V กลับพบว่า เซลล์ทดสอบที่ใช้ขั้วไฟฟ้าร่วมโลหะแพลททินัม (Liq/Pt-DSSC และ GPE/Pt –DSSC) จะมีค่าความ ต้านทาน R_{CE} ต่ำกว่าเซลล์ทดสอบที่ใช้ขั้วไฟฟ้าร่วม NiSe แสดงให้เห็นว่าโลหะแพลททินัมมีสมบัติเชิง เร่งปฏิกิริยารีดักชันบริเวณขั้วไฟฟ้าร่วมที่ดีกว่า NiSe ในสภาวะความหนาแน่นอิเล็กตรอนสูง ตารางที่ 4.6 ข้อมูลค่าพารามิเตอร์ จาก EIS ที่แรงดันไบแอสประมาณ 0.7 V

DSSCs	R _s (ohm)	R _{ct} (ohm)	Z _w (ohm)	R _{ce} (ohm)
Liq/Pt-DSSC	14.0	199.6	29.2	31.5
Liq/NiSe-DSSC	14.2	236.0	34.7	768.4
GPE/Pt-DSSC	23.5	18.2	20.7	79.6
GPE/NiSe-DSSC	19.6	86.2	29.9	362.3

จากตารางที่ 4.6 พบว่าเซลล์ทดสอบที่ใช้อิเล็กโทรไลต์ GPE และขั้วไฟฟ้าร่วม NiSe (GPE/NiSe-DSSC) มีค่าความต้านทาน R_{CT} ต่ำกว่า และความต้านทาน R_{CE} สูงกว่าเซลล์มาตรฐาน Liq/Pt-DSSC ขณะเดียวกันมีค่าความต้านทาน Z_w ในระดับเดียวกับเซลล์มาตรฐาน อุธิบายได้ว่าเมื่อพิจารณาที่ แรงดันไบแอสสูงใกล้เคียงกับแรงดันวงจรเปิดของเซลล์ (V_{OC}) หรือในสภาวะอิเล็กตรอนอิสระมีความ หนาแน่นสูงนั้น วัสดุ NiSe มีสมบัติเชิงเร่งปฏิกิริยารีดักชันบริเวณขั้วไฟฟ้าร่วมต่ำกว่าโลหะแพลททินัม อิเล็กตรอนสามารถแพร่กระจายได้ดีในอิเล็กโทรไลต์ GPE เทียบเท่าการแพร่กระจายในอิเล็กโทรไลต์ เหลว แต่อัตราการตกกลับบริเวณหน้าสัมผัสระหว่าง TiO₂/EL ใน GPE จะสูงกว่าอิเล็กโทรไลต์เหลว ผลวิเคราะห์ EIS สนับสนุนผลการทดลองวัดประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้าของเซลล์ทดสอบทั้ง 4 ประเภทใน ตารางที่ 4.5 แม้เซลล์ทดสอบ GPE/NiSe-DSSC จะให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าเซลล์ทดสอบมาตรฐาน ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ก็มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและความคงทน จึงได้ทดลองศึกษาการขยายขนาด พื้นที่รับแสงของเซลล์ GPE/NiSe-DSSC ในหัวข้อถัดไป

4.10 ผลศึกษาประสิทธิภาพของ DSSC ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารละลายอิเล็กโทรไลต์เทียบ กับเซลล์สุริยะมาตรฐาน โดยมีพื้นที่รับแสงเป็น 2.25 cm²

ผลทดสอบประสิทธิภาพและผลวิเคราะห์ความต้านทานบริเวณหน้าสัมผัสของวัสดุในเซลล์สุริยะของ เซลล์ทดสอบ GPE/NiSe-DSSC ขนาดพื้นที่รับแสง 0.25 cm² ในหัวข้อ 4.8 และ 4.9 แสดงให้เห็น ประสิทธิภาพการถ่ายโอนอิเล็กตรอนบริเวณหน้าสัมผัสของวัสดุต่างชนิดกัน ที่มีผลต่อสมบัติเชิงไฟฟ้า ของเซลล์สุริยะที่ประกอบขึ้นจากวัสดุนั้น หัวข้อนี้จะแสดงผลทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะที่ ผลิตจากอิเล็กโทรไลต์ GPE และขั้วไฟฟ้าร่วม NiSe ที่มีขนาดพื้นที่รับแสง 2.25 cm² เพื่อศึกษาปัจจัย อื่นที่มีผลต่อการขยายขนาดพื้นที่รับแสงของเซลล์สุริยะจากขนาดเล็กสู่ขนาดกลาง เป็นข้อมูลสำหรับ ขยายไปสู่เซลล์ขนาดใหญ่ต่อไป

ตารางที่ 4.7 ประสิทธิภาพและพารามิเตย	อร์ต่างๆของ DSSC	ที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่	วมและสารละลายอิ
เล็กโทรไลต์เทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐาน	ขนาดพื้นที่รับแสง	2.25 cm^2	

DSSCs 2.25 cm ²	V _{oc} (V)	J _{sc} (mA/cm²)	FF	%PCE	R_{s} ($\mathbf{\Omega}$ cm ²)
Liq EL + Pt *	0.68	7.8	0.54	2.8%	21
GPE 8% + Ni _{0.85} Se	0.65	4.8	0.26	0.8%	116
GPE 8% + Ni _{0.85} Se*	0.61	7.4	0.32	1.4%	72

*Apply silver paint to produce conductive paths

จากตารางที่ 4.7 เมื่อขนาดพื้นที่รับแสงของ DSSC เป็น 2.25 cm² พบว่าเซลล์ NiSe/GPE-DSSC ให้ ค่า PCE = 0.8 % น้อยกว่าเซลล์สุริยะมาตรฐานที่ใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์และแพลททินัม (PCE = 2.8%) สันนิษฐานว่าเซลล์สุริยะมีพื้นที่รับแสงเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการกระตุ้นอิเล็กตรอนจำนวนมากขึ้น แต่การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากฝั่งแอโนดไปฝั่งคาโทดทำได้ไม่ดี เนื่องจากความต้านทานไฟฟ้าของ สารเคลือบนำไฟฟ้าบนผิวกระจกยังมีค่าสูงอยู่ การแก้ไขเบื้องต้นใช้สีเพ้นท์เงินทาบนผิวกระจกนำ ไฟฟ้าบริเวณหน้าสัมผัสเพื่อสร้างเส้นทางนำไฟฟ้า (conductive path) ผลทดสอบพบว่าเซลล์ NiSe/GPE-DSSC ที่ทาสีเพ้นท์เงินให้ค่า J_{SC} เพิ่มจาก 4.8 เป็น 7.4 mA/cm² และความต้านทาน อนุกรมลดลงจาก 116 เป็น 72 **Ω** cm²

ค่าความต้านทานอนุกรมสัมพันธ์กับความต้านทานไฟฟ้าบริเวณหน้าสัมผัส (Wiring Contact) ที่ไม่ เป็นไปตามกฎของโอห์ม (non-Ohmic contact) ในทางทฤษฎีความต้านทานอนุกรมควรมีค่าต่ำเพื่อ ลดการสูญเสียอิเล็กตรอนบริเวณหน้าสัมผัสส่งผลให้ค่า FF และ PCE ของเซลล์สุริยะเพิ่มขึ้น จาก ตารางที่ 4.7 จะเห็นว่าผลการทดลองเป็นไปตามทฤษฎี อย่างไรก็ตามค่า PCE ยังต่ำกว่าของเซลล์ มาตรฐาน จำเป็นต้องลดความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมให้ต่ำกว่านี้ ขณะเดียวกันเพิ่มความต้านทานชันท์ ให้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์ก่อนขยายขนาดพื้นที่รับแสงเพิ่มขึ้นต่อไป



รูปที่ 4.17 กราฟ J-V ของเซลล์ NiSe/GPE-DSSC ขนาดพื้นที่รับแสง 2.25 cm²

DSSCs 2.25 cm ²	V _{oc} (V)	J _{sc} (mA/cm²)	FF	%PCE	R _{shunt} (Ohm cm²)	R _{series} (Ohm cm²)
Liq EL/Pt-DSSC*	0.68	7.8	0.54	2.8	157	21
Range of cells	0.68-0.69	7.8-8.1	0.50-0.54	2.7-2.8	150-157	21-25
GPE/Pt-DSSC*	0.61	8.7	0.41	2.1	83	23
Range of cells	0.59-0.61	8.4-8.7	0.40-0.41	2.0-2.1	83-84	22-23
GPE/NiSe-DSSC*	0.61	7.4	0.32	1.4	64	72
Range of cells	0.61-0.63	7.1-7.4	0.27-0.32	1.2-1.4	42-64	72-79

ตารางที่ 4.8 ประสิทธิภาพและพารามิเตอร์ต่างๆของ GPE/Pt-DSSC และ NiSe/GPE-DSSC เทียบ กับเซลล์สุริยะมาตรฐาน ขนาดพื้นที่รับแสง 2.25 cm²

*Apply silver paint to produce conductive paths

กราฟ J-V ของเซลล์ทดสอบ GPE/Pt-DSSC, NiSe/GPE-DSSC และเซลล์มาตรฐานที่วัดได้จากเครื่อง IV-test แสดงดังรูปที่ 4.17 และจากตารางที่ 4.8 พบว่าเซลล์ GPE/NiSe-DSSC* มีค่าความหนาแน่น กระแสไฟฟ้าวงจรปิด (J_{sc} = 7.4 mA/cm²) น้อยกว่าเซลล์ GPE/Pt-DSSC* (J_{sc} = 8.7 mA/cm²) และค่า FF ของเซลล์ GPE/NiSe -DSSC* นั้นต่ำกว่าเซลล์ GPE/Pt-DSSC* เนื่องจากมีความต้านทาน อนุกรมสูงกว่าและมีความต้านทานชันท์ต่ำกว่าเซลล์ GPE/Pt-DSSC* ซึ่งส่งผลให้เซลล์ GPE/NiSe-DSSC* มีค่า PCE = 1.4% น้อยกว่า เมื่อเทียบเซลล์ GPE/Pt-DSSC* (PCE = 2.1%) จากผลวิเคราะห์ความขัดรวมก่อนหน้าในระดับห้องปฏิบัติการ เซลล์ GPE/NiSe-DSSC มีค่าความ

ต้านทานที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสัมผัสสารอิเล็กโทรไลต์กับขั้วไฟฟ้าร่วมสูง แต่เนื่องจากพื้นที่ของสาร
 ต้วเร่งปฏิกิริยาที่ใช้นั้นมีพื้นที่น้อย (0.25 cm²) ดังนั้นเซลล์ GPE/NiSe -DSSC มีค่าประสิทธิภาพ
 โดยรวมต่ำกว่าในระดับที่ยอมรับได้เมื่อเทียบกับเซลล์สุริยะมาตรฐาน แต่เมื่อทำการขยายขนาดเซลล์
 GPE/NiSe -DSSC* ให้มีพื้นที่รับแสงมากขึ้น (2.25 cm²) จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ของสารตัวเร่งปฏิกิริยา

ที่ใช้ให้มีพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สารนิกเกิลเซเลไนด์มีค่าความต้านทานบริเวณหน้าสัมผัสกับสาร อิเล็กโทรไลต์ที่สูงขึ้นด้วย

จากผลวิเคราะห์ในหัวข้อที่ผ่านมาทั้งหมด สามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ อุปสรรคของการขยายขนาดเซลล์สุริยะที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารอิเล็กโทรไลต์ให้มีพื้นที่รับแสง มากขึ้นนั้นคือ สารนิกเกิลเซเลไนด์ที่นำมาใช้เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมแทนที่โลหะแพลททินัมที่ใช้งานได้ดีใน พื้นที่ขนาดเล็ก แต่คุณสมบัติเชิงเร่งปฏิกิริยาของสารนิกเกิลเซเลไนด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้งาน ในพื้นที่กว้างขึ้น



Chulalongkorn University

บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ต้องการพัฒนาต้นแบบมอดูลเซลล์สุริยะเคมีไฟฟ้าเชิงแสงขนาดใหญ่ โดยศึกษาปัจจัยที่มีผล ต่อการขยายส่วนการผลิตมอดูลเซลล์สุริยะ คำนึงถึงประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงาน ต้นทุนในการ ผลิต และความเสถียรภาพของตัวเซลล์สุริยะ

ส่วนแรกเริ่มจากสังเคราะห์สารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ด้วยกระขบวนการไฮโดรเทอร์มอล และ วิเคราะห์ผลของสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมขึ้นด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันยืนยัน องค์ประกอบและโครงสร้างผลึก พบว่าสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้มีโครงสร้างแบบเฮกซะ โกนอล (Hexagonal) ปรากฏยอดกราฟที่ 2**0** = 33.2, 44.8, 50.5, 60.3, 61.7 และ 70.7 องศา ผล การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของอนุภาคสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้ด้วยกล้อง ้จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอนุภาคของสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้มีขนาด อนุภาคประมาณ 0.4 ไมโครเมตร อนุภาคเกาะกันเป็นกลุ่ม มีลักษณะโครงสร้างที่เป็นรูพรุน ส่งผลให้มี พื้นที่ผิวสัมผัสกับสารอิเล็กโทรไลต์เพิ่มมากขึ้น ผลศึกษาการรีดิวซ์และการออกซิไดซ์ของขั้วนิกเกิล เซเลไนด์ที่เตรียมได้เทียบกับขั้วแพลททินัมด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี พบว่าขั้วทำงานนิกเกิล เซเลไนด์ปรากฏตำแหน่งแรงดันไบแอสของยอดกราฟแอโนดิกและแคโทดิกใกล้เคียงกับผลทดสอบ ของขั้วทำงานแพลททินัม นอกจากนั้นขั้วนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้นั้นมีค่าพารามิเตอร์ทั้ง 3 พารามิเตอร์ (ค่า |J_{red}|, ค่า E_{pp} และค่าอัตราส่วน J_{ox}/|J_{red}|) ใกล้เคียงกับขั้วแพลททินัม ดังนั้นขั้ว ้นิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้มีความเหมาะสมพอที่จะใช้แทนขั้วแพลททินัมใน DSSC เพื่อลดต้นทุนใน การผลิต และผลศึกษาความโปร่งแสงของสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้เทียบกับแพลททินัม ด้วย ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ พบว่าสารนิกเกิลเซเลไนด์มีค่าความโปร่งแสง มากกว่า 65% ในช่วงความยาวคลื่น 400-700 nm สามารถใช้ผลิตขั้วไฟฟ้าร่วมที่มีลักษณะโปร่งแสง เพื่อใช้ ประโยชน์ใน Application ที่ต้องการความโปร่งใสได้เช่น การรวมเซลล์สุริยะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ อาคาร (Building Integrated Photovoltaics; BIPV) เป็นต้น

ส่วนที่สองเป็นการสังเคราะห์เจลพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ (GPE) โดยผสมสารอะเซตาไมด์ (0%, 5%, 8% และ10% โดยน้ำหนัก) ในโพลีเอททิลีนออกไซด์ โซเดียมไอโอไดด์ และไอโอดีน และวิเคราะห์ผล ของ GPE ที่เตรียมขึ้น ผลการศึกษาค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว พบว่าปริมาณสารอะเซ ตาไมด์ที่เพิ่มขึ้น 0 – 8% โดยน้ำหนัก ทำให้ GPE มีค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วลดลงจาก -93.5 เป็น -99.2 °C และค่าการเหนี่ยวนำไอออนเพิ่มขึ้นจาก 8.7 x 10⁻⁴ เป็น 19.8 x 10⁻⁴ S/cm แต่ ถ้าเพิ่มปริมาณสารอะเซตาไมด์เป็น 10 % โดยน้ำหนัก ค่าการเหนี่ยวนำไอออนกลับลดลงเนื่องจากอะ เซตาไมด์ปริมาณมากเกินไปจะเหนี่ยวนำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างอะเซตาไมด์กับไตรไอโอ ไดด์ไอออนใน GPE ดังนั้น GPE ผสมสารอะเซตาไมด์ 8 % โดยน้ำหนัก เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสาร อิเล็กโทรไลต์ใน DSSC

ผลทดสอบเซลล์ DSSC ขนาดพื้นที่รับแสง 0.25 cm² ภายใต้สภาพแสง AM 1.5 G ความเข้มแสง 100 mW/cm² พบว่าเซลล์ทดสอบ DSSC ที่ใช้สารนิกเกลเซเลไนด์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วม (NiSe-DSSC), เซลล์ DSSC ที่ใช้ GPE ผสมสารอะเซตาไมด์ 8 % โดยน้ำหนัก (GPE-DSSC) และเซลล์ทดสอบ DSSC ที่ใช้ ทั้งสารนิกเกลเซเลไนด์เป็นขั้วไฟฟ้าร่วมและใช้ GPE ผสมสารอะเซตาไมด์ 8 % โดยน้ำหนัก (NiSe/GPE-DSSC) ให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดในการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้า (PCE) เท่ากับ 2.60%, 2.66% และ 2.20% ตามลำดับ เทียบกับผลทดสอบของเซลล์มาตรฐานที่ใช้ขั้วไฟฟ้า ร่วมแพลททินัมและอิเล็กโทรไลต์เหลว (PCE = 3.0%) พบว่าเซลล์ทดสอบทั้ง 3 ประเภทมีสมรรถนะ ต่ำกว่าในระดับที่ยอมรับได้ (มีค่าประสิทธภาพโดยรวมไม่ต่ำกว่า 75% ของเซลล์มาตรฐาน) แต่มีข้อดี คือต้นทุนการผลิตถูกกว่าและเสถียรกว่าการใช้โลหะแพลททินัมและอิเล็กโทรไลต์เหลว มีศักยภาพใน การขยายขนาดพื้นที่รับแสงต่อไป

ผลทดสอบสมรรถนะของเซลล์ NiSe/GPE-DSSC ที่ขยายขนาดพื้นที่รับแสงเป็น 2.25 cm²ในเบื้องต้น พบว่าให้ค่า PCE = 0.8% ซึ่งต่ำกว่าผลทดสอบของเซลล์มาตรฐานที่มีขนาดพื้นที่รับแสงเท่ากัน (PCE = 2.8%) หลังจากทดลองสร้างช่องทางนำไฟฟ้า (conductive path) บนผิวขั้วไฟฟ้าทั้งสองด้านของ เซลล์ทดสอบด้วยสีเพ้นท์เงิน (silver paint) พบว่าค่า PCE เพิ่มขึ้นจาก 0.8% เป็น 1.4% เนื่องจาก ช่องทางนำไฟฟ้าช่วยให้อิเล็กตรอนถ่ายโอนได้ดีขึ้นบริเวณผิวหน้าตัวรองรับกระจกเคลือบสารนำไฟฟ้า เกิดเป็นกระแสไฟฟ้ามากขึ้น

และผลทดสอบสมรรถนะของเซลล์ NiSe/GPE-DSSC* (ผ่านการสร้างช่องทางนำไฟฟ้า) มีค่าต่ำกว่า เปรียบเทียบกับเซลล์ GPE/Pt-DSSC* (PCE = 2.1%) ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออุปสรรคของการขยาย ขนาดเซลล์สุริยะที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสารอิเล็กโทรไลต์ให้มีพื้นที่รับแสงมากขึ้นนั้น คือ สมบัติ เชิงเร่งปฏิกิริยาของสารนิกเกิลเซเลไนด์ที่ลดลงเมื่อขยายขนาดเซลล์สุริยะให้มีพื้นที่รับแสงมากขึ้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

การผลิตต้นแบบมอดูลเซลล์สุริยะเคมีไฟฟ้าเชิงแสงขนาดใหญ่ ควรต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการ เปลี่ยนรูปพลังงานเป็นหลัก จากผลการทดลองพบว่าเซลล์สุริยะที่ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าร่วมและสาร อิเล็กโทรไลต์ ขนาดพื้นที่รับแสง 2.25 cm² มีค่าฟิลล์แฟกเตอร์ต่ำ (FF = 0.32) และให้ค่า ประสิทธิภาพเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับผลทดสอบเซลล์มาตรฐานที่มีขนาดพื้นที่รับแสงเท่ากัน สาเหตุแรกในทางทฤษฏีขนาดพื้นที่รับแสงแปรผันตรงกับความต้านทานไฟฟ้าอนุกรม (R_{series}) ของ เซลล์สุริยะ ยิ่งเซลล์สุริยะมีพื้นที่รับแสงเฟิรขั้นย่อมมี R_{series} เพิ่มขึ้นด้วย แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ เช่น การใช้เครื่อง ultrasonic soldering สร้างหน้าสัมผัสของเซลล์เพื่อลดค่า R_{series} บริเวณจุดเชื่อมต่อ และอีกสาเหตุหนึ่งคือตัวเซลล์ทดสอบมีความต้านทานชันท์ (R_{shunt}) ภายในเซลล์ต่ำเกินไป ซึ่งอาจเกิด จากตัวเซลล์ทดสอบนั้นมีค่า charge transfer resistance (R_{CT}) ต่ำ ส่งผลให้เกิดการตกกลับของ อิเล็กตรอนจากชั้น TiO₂ สู่สารอิเล็กโทรไลต์ได้ง่าย แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ เช่น ทดลองเพิ่มความ เข้มข้นของสาร TiCl₄ สำหรับนำมาใช้ในขั้นตอน Post-treatment และสารนิกเกิลเซเลไนด์ที่นำมาใช้ นั้นมีความต้านทานที่สูงขึ้นบริเวณหน้าสัมผัสกับสารอิเล็กโทรไลด์เมื่อเซลล์มีขนาดพื้นที่รับแสงเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรทดลองเปลี่ยนสารตัวเร่งปฏิกิริยาที่นำมาใช้เป็นขึ้ดไขน้าดี้มูฟ้าร่วม

นอกจากนั้นการลดการสูญเสียหรือการลดการตกกลับของอิเล็กตรอนบริเวณหน้าสัมผัสของ องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบภายใน DSSC ช่วยเพิ่มความต้านทานชันท์ได้ ส่งผลให้ค่า FF และ ประสิทธิภาพของเซลล์ดีขึ้นถึงในระดับที่ยอมรับได้ นำไปสู่การขยายขนาดพื้นที่รับแสงของมอดูล DSSC เพิ่มขึ้นอีกในขั้นตอนถัดไป

รายการอ้างอิง

- 1. The Alliance for Sustainable Energy, LLC. , NATIONAL CENTER FOR PHOTOVOLTAICS. 2015; Available from: <u>http://www.nrel.gov/ncpv/</u>.
- 2. *iEnergyGuru*. Available from: <u>https://ienergyguru.com/2015/06/</u>.
- Vinich Promarak, S.S., Taweesak Sudyoadsuk and Tinnagon Keawin. *Dye-Sensitized Solar Cells*. Available from: www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2013032015072362.pdf.
- 4. Chuangchote, D.S. *Nanotechnology of Dye-Sensitized Solar Cells*. Available from: <u>http://www.kmutt.ac.th/hynae/th/</u>.
- 5. Yella, A., et al., *Porphyrin-sensitized solar cells with cobalt (II/III)–based redox electrolyte exceed 12 percent efficiency.* science, 2011. **334**(6056): p. 629-634.
- Kalnaowakun, P. Prepapation and Characterization of Coating Material as a Catalyst for Counter Electrode of Dye-Sensitized Solar Cell. Available from: <u>http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/9451/1/374496.pdf</u>.
- Mr.Phasapon Manosukritkul , D.P.P., Miss.Sirikwan Sudwatkeaw. Study Dyesensitizer on Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells. Available from: <u>http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/177375/ea2056efa5535d2c20e856114b</u> <u>bb423e?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2015.6</u>.
- 8. Gong, F., et al., *In situ growth of Co(0.85)Se and Ni(0.85)Se on conductive substrates as high-performance counter electrodes for dye-sensitized solar cells.* J Am Chem Soc, 2012. **134**(26): p. 10953-8.
- 9. Development of low cost counter electrode DSSC. Available from: http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=23292.
- 10. Wootthikanokkhan, A.P.D.J. *Perovskite's material harvesting light for solar cell in the future*. Available from: <u>http://www.kmutt.ac.th/hynae/perovskite/</u>.
- Dias, F.B., L. Plomp, and J.B. Veldhuis, *Trends in polymer electrolytes for secondary lithium batteries.* Journal of Power Sources, 2000. 88(2): p. 169-191.

- Stephan, A.M., *Review on gel polymer electrolytes for lithium batteries.*European polymer journal, 2006. 42(1): p. 21-42.
- 13. *iEnergyGuru4*. Available from: <u>https://ienergyguru.com/2015/04/</u>.
- 14. NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY. Available from: https://www.nrel.gov/rredc/.
- SENATAM, M.C. THE PORTABLE MEASUMENT I-V CURVE OF SOLAR CELL PANEL.
 2014; Available from: http://hrd.rmutl.ac.th/qa/docUpload/pj/3509900754841/150827122129fullpp. pdf.
- 16. Honsberg, S.B.a.C. *PVCDROM*. Available from: <u>http://www.pveducation.org/pvcdrom/instructions</u>.
- 17. Hunsom, P.D.M., PEM fuel cell and Electrochemical analysis. 2555.
- Dai, S., et al., *Design of DSC panel with efficiency more than 6%*. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2005. 85(3): p. 447-455.
- Kim, H., et al., Design and analysis of a highly reliable large-area Z-type transparent module for dye-sensitized solar cells. Solar Energy, 2017. 155: p. 585-592.
- Renan Escalante, M.F.-P., R. Garcia-Rodriguez, G. Oskam. *Dye sensitized solar* cell scale-up : from cell to module. Available from: <u>https://www.researchgate.net/publication/271504719_Dye-</u> <u>sensitized solar cell scale up from cell to module</u>.
- Jia, J., et al., *Transparent nickel selenide used as counter electrode in high efficient dye-sensitized solar cells.* Journal of Alloys and Compounds, 2015.
 640: p. 29-33.
- 22. Pavithra, N., A.M. Asiri, and S. Anandan, *Fabrication of dye sensitized solar cell using gel polymer electrolytes consisting poly(ethylene oxide)-acetamide composite.* Journal of Power Sources, 2015. **286**: p. 346-353.
- Anantharaj, G., et al., Fabrication of Stable Dye Sensitized Solar Cell with Gel electrolytes Using Poly(ethylene oxide)-Poly(ethylene glycol). Electrochimica Acta, 2015. 176: p. 1403-1409.

- 24. Sun, H., et al., *In situ preparation of a flexible polyaniline/carbon composite counter electrode and its application in dye-sensitized solar cells.* The Journal of Physical Chemistry C, 2010. **114**(26): p. 11673-11679.
- 25. Cheng, W.-Y., C.-C. Wang, and S.-Y. Lu, *Graphene aerogels as a highly efficient counter electrode material for dye-sensitized solar cells.* Carbon, 2013. **54**: p. 291-299.
- 26. Polymeric Materials. Available from: http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2014_08/22/%E0%B8%9A%E0%B8% 97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2013%20Polymers.pdf









ภาคผนวก ก.

ภาคผนวก ข.



อนุภาคของสารประกอบนิกเกิลเซเลไนด์ที่เตรียมได้มีขนาดค่อนข้างเล็ก มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 0.3-0.5 ไมโครเมตร ซึ่งจากรูปภาพ SEM ทั้ง 3 รูป อนุภาคมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 0.4 ไมโครเมตร

ภาคผนวก ค.

DSSCs 0.25 cm ²	Samples	V _{oc} (V)	J _{sc} (mA/cm²)	FF	%PCE
	STD1	0.68	6.9	0.65	3.0%
Liq EL + Pt	STD2	0.67	6.3	0.66	2.8%
	STD3	0.65	7.1	0.64	2.9%
	N1	0.67	5.8	0.66	2.6%
Liq EL + Ni _{0.85} Se	N2	0.66	5.5	0.60	2.2%
	N3	0.63	6.0	0.64	2.4%
	W1	0.71	5.6	0.64	2.6%
GPE 8% + Pt	W2	0.71	4.3	0.69	2.1%
	W3	0.70	5.0	0.67	2.3%
GPE 8% + Ni _{0.85} Se	H1	0.72	6.5	0.46	2.2%
	พา ^{H2} เกร	ณ์ 0.70 วิท	ยาลั6.3	0.47	2.1%
	ULAH3NG	0.72	VER 6.3	0.45	2.0%





ภาคผนวก จ.

DSSCs 2.25 cn	s n ²	V _{oc} (V)	J _{sc} (mA/cm²)	FF	%PCE	R _{shunt} (Ohm cm²)	R _{series} (Ohm cm²)
Liq EL/Pt-	E1	0.68	7.8	0.54	2.8%	157	21
DSSC*	E2	0.69	8.1	0.50	2.8%	150	25
	E3	0.69	7.9	0.51	2.7%	154	25
GPE/Pt-	01	0.61	8.7	0.41	2.1%	83	23
DSSC*	02	0.63	8.4	0.40	2.0%	84	22
GPE/NiSe-	К4	0.61	7.4	0.32	1.4%	64	72
DSSC*	К3	a 0.63 a v	กรถวีมหาวิ	0.26	g 1.3%	42	79
	K5	0.61	IGKORN U 7.1	0.30	1.3%	59	73

*Apply silver paint to produce conductive paths

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายวีระยุทธ์ เก้าเอี้ยน เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2534 สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในปีการศึกษา 2552 สำเร็จการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาปิโตร เคมีและวัสดุพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และเข้าต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคนิค ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 และเข้าร่วมประชุมวิชาการ TIChE & ITIChE 2016 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานแบบ โปสเตอร์ในหัวเรื่อง "การพัฒนามูอดูลเซลล์สุริยะเคมีไฟฟ้าเชิงแสงต้นทุนต่ำ"

